

TiO₂/ERGO/ITO NANOKOMPOZİT ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Elif TEMUR

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Analitik Bilim Dalı Prof. Dr. Ümit DEMİR 2017 Her Hakkı Saklıdır

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TiO₂/ERGO/ITO NANOKOMPOZİT ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Elif TEMUR

KİMYA ANABİLİM DALI Analitik Bilim Dalı

ERZURUM 2017

Her hakkı saklıdır



T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

TEZ ONAY FORMU



TiO₂/ERGO/ITO NANOKOMPOZİT ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Prof. Dr. Ümit DEMİR danışmanlığında, Elif TEMUR tarafından hazırlanan bu çalışma 05/07/2017 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Bilim Dalı'nda yüksek lisans tezi olarak **oybirliği** ile kabul edilmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Ümit DEMİR

Üye : Prof. Dr. Songül DUMAN

Üye : Doç. Dr. Tuba ÖZNÜLÜER

imza : Unit deus imza : Compi İmza :

Yukarıdaki sonuç;

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 06.07./2017 tarih ve ... 27..../. 50...... nolu kararı ile onaylanmıştır.

C. fm

Prof. Dr. Cavit KAZAZ Enstitü Müdürü

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaklardan yapılan bildiriş, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak olarak kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

TiO₂/ERGO/ITO NANOKOMPOZİT ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Elif TEMUR

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Analitik Bilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ümit DEMİR

Fotovoltaik uygulamalarda oldukça önemli bir malzeme olan TiO₂, katodik elektrodepozisyon tekniği kullanılarak doğrudan ITO elektrot yüzeyinde biriktirildi. Titanyum tuzu kaynağı olarak da TiCl₃ ve TiOSO₄ kullanılarak yapılan voltametrik çalışmalarda, her iki tuzun TiO₂ depozisyonu için seçilebileceği ancak TiCl₃'ün klor bileşiminin değişmesinden dolayı TiOSO4 tuzunun daha uygun olduğu görüldü. TiOSO4 ortamında -1100 mV'ta 2 saatlik depozisyon sonrasında ara tür olan TiO(OH)2 formu elde edildi. TiO(OH)₂ ara ürünü 400°C'de 2 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulduğunda TiO₂ anataz kristal yapısı oluşturuldu. ITO substrat üzerinde depozit edilen TiO₂ filmi XRD, XPS, EDS ve SEM teknikleri kullanılarak karakterize edildi. TiO2/ERGO yapılarının sentezi için GO ile TiOSO₄ çözeltileri karıştırıldı ve -1100 mV sabit potansiyel değerinde elektrokimyasal depozisyon yapıldı. GO'in elektrokimyasal indirgenmesiyle elde edilen ERGO yapısı üzerinde eşzamanlı olarak TiO2'in elektrodepozisyon sonucu TiO2-ERGO nanokompozitleri sentezlendi. Elektrot materyali yüzeyinde sentezlenen bu kompozit malzemenin karakterizasyonu XRD, XPS, SEM ve EDS teknikleri kullanılarak yapıların karakterizasyon işlemleri, TiO₂/ERGO/ITO kompozit yapının elektrokimyasal teknik ile başarılı bir şekilde sentezlenebileceğini gösterdi.

2017, 93 sayfa

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit, elektrokimyasal depozisyon, metal oksit, TiO₂, nanokompozit.

ABSTRACT

Master Thesis

ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TiO₂/ERGO/ITO NANOCOMPOSITE ELECTRODES

Elif TEMUR

Atatürk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Analytical Science

Supervisor: Prof. Dr. Ümit DEMİR

TiO₂, which is a very important material in photovoltaic applications, was directly deposited on the ITO electrode surface using cathodic electrodeposition technique. In the voltammetric studies, where both TiCl₃ and TiOSO₄ were used as the salt source, it was found that the TiOSO₄ salt was more suitable for TiO₂ formation due to the change of the chlorine composition of TiCl₃. The TiO(OH)₂ form, which is the intermediate product, was obtained after 2 hours of deposition at -1100 mV in the TiOSO₄ solution. The TiO₂ anatase crystal structure was formed when the TiO(OH)₂ intermediate was annealed at 400°C for 2 hours. The deposited TiO₂ film on the ITO substrate was characterized using XRD, XPS, EDS and SEM techniques. Electrochemical deposition of TiO₂-ERGO was performed at a constant potential of -1100 mV from the mixed solution of GO and TiOSO₄ yielded TiO₂/ERGO composit structures. Characterization of this composite material was investigated using XRD, XPS, SEM and EDS techniques. The characterization process showed that the composite structure could be successfully synthesized by electrochemical technique.

2017, 93 pages

Keywords: Electrochemically reduced graphene oxide, electrochemical deposition, metal oxide, TiO₂, nanocomposite

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın yüksek lisans tezi olarak planlanması ve yürütülmesi esnasında engin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile her anlamda bana yardımcı olan, davranış, fikir ve düşüncelerini örnek aldığım, yanında çalışmaktan onur duyduğum değerli hocam, danışmanım Sayın Prof. Dr. Ümit DEMİR'e teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmalarım esnasında samimiyeti ve içtenliği ile desteğini esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Tuba ÖZNÜLÜER'e, kapısını her çaldığımda güler yüzünü eksik etmeyen, pozitif düşünceleriyle bana güç veren her daim desteğini ve güvenini hissettiğim Sayın Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK DOĞAN'a, çalışma grubu arkadaşlarım Bingül KURT URHAN'a, Mesut ERYİĞİT'e ve Analitik Kimya Anabilim dalındaki tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Her adımda verdikleri destek, moral ve sayısız yardımlar için değerli dostlarım Elif AK, Elanur DAŞBAŞI ve Eftade Pınar GÜR'e teşekkür ederim.

Son olarak bu günlere gelmem de sonsuz emeğe sahip olan hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme, özellikle bana hem baba hem abi olan Emre TEMUR'a sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Elif TEMUR Haziran, 2017

İÇİNDEKİLER

ÖZET	i
ABSTRACT	ii
TEŞEKKÜR	iii
SİMGELER DİZİNİ	vi
ŞEKİLLER DİZİNİ	viii
ÇİZELGELER DİZİNİ	xi
1. GİRİŞ	1
1.1. Titanyum Dioksit	2
1.1.2. TiO ₂ özellikleri ve kristal yapıları	3
1.1.3. TiO ₂ 'in sentez yöntemleri	5
1.1.3.a. Hidrotermal sentez	6
1.1.3.b. Solvotermal sentez	7
1.1.3.c. Sol-jel yöntemi	7
1.1.3.d. Kimyasal buhar depozisyonu (CVD)	9
1.1.3.e. Sonokimyasal ve mikrodalga sentez	11
1.1.3.f. Elektrokimyasal sentez	11
1.4. TiO ₂ -Grafen nanokompozitler	14
1.5. TiO ₂ -Grafen nanokompozitlerinin uygulama alanları	16
2. KAYNAK ÖZETLERİ	19
2.1. TiO ₂ 'in Elektrokimyasal Sentezi	19
2.2. GO'in Elektrokimyasal İndirgenmesi	
3. MATERYAL ve YÖNTEM	44
3.1. Materyal	44
3.1.1. Elektrokimyasal hücreler	44
3.1.1.a. Referans elektrot	46
3.1.1.b. Karşıt elektrotlar	50
3.1.1.c. Çalışma elektrodu	50
3.1.2. Grafit oksitin sentezi	
3.1.3. Kimyasallar	53

3.1.4. Potansiyostat	53
3.1.5. Tavlama işlemi	55
3.2. Yöntemler	56
3.2.1. Dönüşümlü voltametri	56
3.2.2. Karakterizasyon yöntemleri	59
3.2.2.a. X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS)	59
3.2.2.b. X-ışınları kırınımı (XRD)	61
3.2.2.c. Taramalı elektron mikroskobu (SEM)	64
3.2.2.d. Enerji dağılımlı spektroskopi (EDS)	66
4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA	67
4.1. TiO ₂ 'in Katodik Depozisyonu	67
4.2. TiO ₂ /ERGO Nanokompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi	70
4.3. TiO ₂ Filmlerinin Yapısal ve Morfolojik Karakterizasyonu	72
4.3.1. TiO ₂ filmlerinin yapısal karakterizasyonu	72
4.3.2. TiO ₂ fimlerinin morfolojik karakterizasyonu	79
4.4. TiO ₂ -ERGO Kompozitinin Yapısal Karakterizasyonu	81
4.5. TiO ₂ -ERGO Kompozitinin Morfolojik Karakterizasyonu	85
5. SONUÇ	
KAYNAKLAR	
ÖZGEÇMİŞ	94

SİMGELER DİZİNİ

А	Amper
Å	Angstrom
С	Konsantrasyon
cm	Santimetre
d	Ortalama partikül boyutu
dk	Dakika
e	Elektron
Е	Enerji
eV	Elektron volt
F	Faraday sabiti
g	Gram
h	Planck sabiti
kV	Kilovolt
L	Litre
Μ	Molar
m	Kütle
mg	Miligram
mL	Mililitre
mm	Milimetre
mM	Milimolar
mV	Milivolt
n	Elektron sayısı
nA	Nanoamper
nm	Nanometre
0	Derece
S	Saniye
Т	Sıcaklık
t	Zaman
V	Volt

- Z Kütle numarası
- $\beta_{1/2}$ Kırınım pikinin yarı pik genişliğinin θ cinsinden açı değeri
- λ Dalga boyu
- μ Mikro
- μA Mikroamper
- μm Mikrometre
- υ Tarama Hızı



ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1. TiO2'in üç fazının kristal yapısı
Şekil 1.2. Otoklav görüntüsü6
Şekil 1.3. Sol-Jel Sentez yöntemleri9
Şekil 1.4. CVD işlem basamakları10
Şekil 1.5. Grafen-TiO ₂ nanokompozit oluşumu16
Şekil 2.1. Ti levha elektrotta TiO2'nin anodik depozisyonuna ait dönüşümlü
voltamogramı
Şekil 2.2. Ti elektrot yüzeyinde anodik depozit edilmiş TiO ₂ nanotüplerinin SEM
görüntüsü21
Şekil 2.3. TiCl ₃ ve NaNO ₃ çözelti karışımlarının fotoğrafları23
Şekil 2.4. 0,47M HCl (1,4), 25mM TiCl ₃ + 0,47M HCl (2,5), ve 25mM
$TiCl_3 + 0,47M HCl + 75mM NaNO_3 (3,6)$ elektrolitlerinde (1-3) Ti ve
(4-6) TiO ₂ /Ti elektrotlara ait 5 mV.s ^{-1} tarama hızında ve 25°C'de alınan
doğrusal tarama voltamogramları24
Şekil 2.5. Tavlanmamış (a), 200°C'de (b) ve 500°C'de (c) 1saat tavlanmış
numunelere ait FTIR spektrumları25
Şekil 2.6. 0,02 M TiOSO ₄ , 0,03 M H_2O_2 ve 0,1 M KNO ₃ çözeltisinde -1,1 V'ta
katodik depozit edilmiş ve 400°C'de 1 saat ısıl işleme tabi tutulmuş
TiO ₂ 'in XRD spektrumu27
Şekil 2.7. X-ışını kırınımı desenleri
Şekil 2.8. CP tekniği (A ve B) ve PRP tekniği (C-H) ile sentezlenen TiO ₂ 'in SEM
görüntüleri29
Şekil 2.9. a) Au(111) substrat yüzeyine depozit edilen ERGO filminin geniş ölçekli
STM görüntüsü b) Boşluk kusurları (A) ve adsorplanmış atomları (adatom)
(B) gösteren atomik boyutlu STM görüntüsü (
Şekil 2.10. (A) ERGO'nun SEM görüntüsü. (B) 20 µg mL ⁻¹ için UV–vis
spektroskopisi (a) GO (b) ERGO. Sağ üstteki fotoğraflar GO ve ERGO
dispers çözeltilerini göstermektedir. Sol alt ERGO dispers çözeltisinin

büyütülmüş görüntüsüdür. (C) Farklı pH'lar altında GO'in ve ERGO'in
Zeta Potansiyeli
Şekil 2.11. pH 2'de (a) ve pH 12'de (b) 0.1 M fosfat tamponu içerisinde 10 mV/s
tarama hızında GO film indirgemesinin dönüşümlü voltomogramı35
Şekil 2.12. GO'in elektrokimyasal indirgenmesinde kullanılan hücre şekli
Şekil 2.13. 0,1 M KNO ₃ çözeltisinde indirgememiş GO ve 20 dakika, 30 dakika ve
1 saatlik elektrokimyasal olarak indirgenmiş GO süspansiyonunun
eksfoliyasyon görüntüleri
Şekil 2.14. TiO ₂ kullanılarak GO'in fotokatalitik indirgenmesi
Şekil 2.15 . TiO ₂ -İndirgenmiş grafen oksit nanokompozit sentez şeması
Şekil 2.16. TiO ₂ nanotüp (TNT) üzerine elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen
oksit (ERGO)'in hazırlanış şeması)41
Şekil 2.17. (a) 16 çevrim, (b) 26 çevrim ve (c) 36 çevrim ile TNT üzerine
elektrodepozit edilmiş ERGO elektrotların FESEM görüntüleri (d) 30,
40 ve 50 mV/s'de 36 çevrim için ERGO'in Raman spektrumu42
Şekil 2.18. Ti/TiO ₂ /GO elektrot için; 8, 10 ve 25 çevrim'de anodik eğrileri ve
pozitif tarama sırasında gözlenen anodik CV piki43
Şekil 3.1. İki (a) ve üç (b) elektrotlu elektrokimyasal hücre sistemleri
Şekil 3.2. Çalışmamızda kullanılan elektrokimyasal hücre sistemi gösterimi
Şekil 3.3. Standart hidrojen referans elektrot (SHE)
Şekil 3.4. Doygun kalomel referans elektrot (SCE)
Şekil 3.5. Ag/AgCl referans elektrodu
Şekil 3.6. Pt tel karşıt elektrotlar. 50
Şekil 3.7. Camsı karbon çalışma elektrodu
Şekil 3.8. İndium kalay oksit (ITO)
Şekil 3.9. GO sentezinin şematik özeti
Şekil 3.10. Bir potansiyostat düzeneği ve BAS100W elektrokimyasal analizörü55
Şekil 3.11. Tavlama firini resmi 56
Şekil 3.12. Dönüşümlü, dönüşümsüz ve yarı dönüşümlü voltamogramlar
Şekil 3.13. XPS yönteminin temel prensibi
Şekil 3.14. XPS spektrumu oluşumunun şematik gösterimi
Şekil 3.15. XRD cihazının çalışma prensibi 62

Şekil 3.16. Bir X-ışını tüpü	63
Şekil 3.17. SEM cihazının çalışma prensibi	65
Şekil 4.1. TiCl ₃ çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan dönüşümlü	
voltamogram	67
Şekil 4.2. 0,04M TiOSO ₄ , 0,1M KNO ₃ ve 0,2M H_2O_2 çözeltisinde 100 mV/s	
tarama hızında ITO elektrodun dönüşümlü voltamogramı	69
Şekil 4.3. TiOSO ₄ çözeltisinde meydana gelen renk değişimi	70
Şekil 4.4. ITO elektrodun GO çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan	
dönüşümlü voltamogramı	71
Şekil 4.5. TiOSO ₄ ile GO karışım çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan	
dönüşümlü voltamogram	72
Şekil 4.6. Ti O_2 ince filmlerinin a) tavlama öncesi b) tavlama sonrası XRD	
spektrumları	74
Şekil 4.7. Farklı sürelerde depozit edilen TiO ₂ filmlerinin XRD spektrumları	
a) 10 saat b) 3 saat	75
Şekil 4.8. TiO ₂ filminin XPS spektrumu	76
Şekil 4.9. Ti 2p orbital elektronlarının XPS spektrumu	77
Şekil 4.10. O1s orbital elektronunun XPS spektrumu	78
Şekil 4.11. TiO ₂ filminin EDS spektrumu	79
Şekil 4.12. TiO ₂ filminin tavlama öncesi alınan SEM görüntüsü	80
Şekil 4.13. TiO ₂ filminin tavlama sonrası alınan SEM görüntüsü	81
Şekil 4.14. TiO ₂ -ERGO kompozitinin tavlama öncesi ve sonrası alınan XRD	
spektrumları	82
Şekil 4.15. TiO ₂ ve TiO ₂ -ERGO kompozitinin XRD spektrumları	83
Şekil 4.16. TiO2-ERGO kompozitinin XPS spektrumu	84
Şekil 4.17. Kompozit malzeme için C1s bölgesine ait XPS spektrumu	84
Şekil 4.18. TiO2-ERGO kompozitinin EDS spektrumu	85
Şekil 4.19. ITO yüzeyine depozit edilen ERGO filminin SEM görüntüsü	86
Şekil 4.20. TiO ₂ -ERGO kompozitine ait SEM görüntüsü	87

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1.1. TiO ₂ 'in yapısal özellikleri	3
Çizelge 2.1. Elektrokimyasal indirgeme işlemleri	.30



1. GİRİŞ

Genellikle yalıtkan ya da yarıiletken özelliğe sahip metal oksitler, kimya, fizik ve materyal bilimi gibi pek çok alanda önemli rol oynarlar. Metal oksitlerin yasak enerji aralıklarının geniş olması, p-n bağlantılarının oluşması ve çevresel uyumlulukları elektrot malzemesi olarak onları daha avantajlı kılmıştır. Teknolojik uygulamalarda oksit yapıları mikroelektronik devreler, sensörler, piezo elektrik aygıtları, yakıt hücreleri, korozyona karşı yüzey pasive edici ve katalizör olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca metal oksitler fotokatalitik sistemlerde yarıiletken fotokatalizör olarak kullanılmaktadırlar. Bu sistemlerde, fotokatalitik reaksiyon boyunca kararlı yapıya sahip olmalarından dolayı Titanyum dioksit (TiO₂), ZnO, WO₃, CdS, ZnS, SrTiO₃, SnO₂, Fe₂O₃, GaP, GaAs gibi yarıiletkenler fotokatalizör olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılan yarıiletken ise 3,2 eV yasak enerji aralığına sahip olan TiO₂'dir.

1972'de Fujishima ve Honda ultroviole (UV) ışık altında TiO₂ elektrodunun suyun fotokatalitik parçalanmasında çok etkili olduğunu keşfetmiş, organik atıklardan dolayı oluşan çevre problemlerinin çözümlenmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu açıklamıştır. Bu yöntemle zararlı organik bileşikler karbon dioksit (CO₂) ve su (H₂O) gibi bileşiklere dönüştürülmektedir. Ayrıca 20. yüzyılın başları itibariyle TiO₂ pigment, boya, ilaç ve kozmetik endüstrisi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 TiO_2 farklı elektriksel, kimyasal ve optik özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılan bir metal oksittir. TiO_2 geniş yasak bant aralığına ve yüksek kırma indisine sahiptir. Ayrıca dalga boyu spektrumu geniş bir aralıkta ve yüksek bir geçirgenliğe sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı Titanyum dioksit fotovoltaikler, fotokatalizler, sensörler ve elektrokromikler gibi gelecek vaad eden birçok uygulamalarda araştırılmıştır.

Bu üstün özelliklere ve geniş uygulama alanına sahip TiO₂'in sentezlenmesi için pek çok metot geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları Sol-Jel sentez, kimyasal buhar biriktirme (CVD), fiziksel buhar biriktirme (PVD) hidrotermal sentez ve elektrokimyasal depolamadır. Düşük maliyeti, deneysel kolaylığı, istenilen boyutlarda substrat kullanılabilmesi, düşük sıcaklıklarda ince film elde edilebilmesi ve film kalınlığının istenilen parametreler ile kontrol edilebilmesi, çevre dostu olması gibi avantajlar ile elektrokimyasal depolama yöntemi en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

1.1. Titanyum Dioksit

Titanyum, periyodik cetvelde 4. periyot IVB grubunda bulunur. Atom numarası 22, atom ağırlığı ise 47,90'dır. Elektronik konfigürasyonu $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ şeklindedir. Erime noktası 1850°C, kaynama noktası 3287°C, özgül ağırlığı 4,5 g/cm³'tür. Nadir bir element olarak bilinirse de yer kabuğunda en çok bulunan altıncı elementtir. Kütle numaraları 43'ten 51'e kadar olan çeşitli izotopları vardır. Tabiatta bulunan ve kararlı olan izotoplarının kütle numaraları 46, 47, 48, 49 ve 50'dir. Diğer izotopları ise radyoaktiftir. Titanyumun oksidasyon basamakları +2, +3 ve +4'tür. Fiziksel ve kimyasal açıdan üstün özellikler göstermesinin yanı sıra hafif, güçlü, parlak ve korozyona karşı oldukça dirençlidir. Titanyum metalik halde kuvarsı çizebilecek kadar sert bir elementtir. Sıkı istiflenmiş hekzagonal kafes yapısına sahip bir metaldir. Paslanmaz çelik ve kobalt alaşımlarına göre daha hafif bir malzemedir. Titanyum demir, alüminyum, vanadyum, molibden gibi elementler ile alaşım yapabilir. Titanın oksijene, karbona ve azota ilgisi çok fazladır. En yaygın bileşiği titanyum dioksit (TiO₂)'tir.

Titanyum beyazı ya da titanyum pigmenti olarak adlandırılan TiO₂, 1821 yılında keşfedilmiş ve teknolojik uygulamaların çoğunda kullanılmıştır. Geniş bant aralığı, yüksek elektron bağlanma enerjisi ve görünür ışıkta yüksek geçirgenliği fotoelektronik cihazlar için TiO₂'i ideal bir malzeme yapmaktadır (Chen and Mao 2006). TiO₂ fotokatalizör olarak heterojen katalizlerde, hidrojen ve elektrik enerjisi üretimi için güneş pillerinde, gaz sensörlerinde, beyaz pigment olarak boya ve kozmetik ürünlerinde, korozyon koruyucu kaplamalarda, varistör gibi elektrikli aletlerde, seramiklerde ve optik kaplamalarda kullanılır (Pfaff and Reynders 1963). Ayrıca TiO₂ nanoyapılarının lityum temelli pillerde ve elektrokromik aletlerde uygulamaları vardır.

 TiO_2 'in fotovoltaik güneş pillerinde önemli uygulamaları bulunur. Güneş pillerinde TiO_2 arayüzeyine boya, konjuge polimer ya da yarıiletken nanokristal malzeme modifiye edilerek güneş enerjisinin dönüşümü ve absorblanması kolaylaştırılmıştır (O'Regan and Gratzel 1991).

1.1.2. TiO₂ özellikleri ve kristal yapıları

İkili bileşik yarıiletkenlerden biri olan TiO₂ titanyum (Ti) atomu ile oksijen (O) atomunun iyonik ve kovalent bağlarla biraraya gelmesiyle oluşur. Literatürde TiO₂'in farklı yapılara sahip onbir farklı polimorftan oluştuğu rapor edilmiştir (Swamy *et al.* 2001). Anataz, rutil ve brukit doğada en bol miktarda bulunan üç polimorf halidir. Her üç kristal yapı, kenarları ve köşeleri ile farklı şekilde bağlanmış TiO₆ oktahedralinden oluşur. Brukit ortorombik, anataz ve rutile tetragonal yapıdadır (Şekil 1.1). TiO₂'in nano boyutta uygulamaları kristal faz, partikül boyutu, yüzey alanı ve termal kararlılığına bağlıdır (Gablenz *et al.* 1998). TiO₂'in üç kristal yapısına ait değişen yapısal özellikleri Çizelge 1.1'de karşılaştırılmıştır.

S.N.	Özellik	Rutile TiO₂	Anataz TiO ₂	Brukit TiO ₂
1.	Formül Ağırlığı	79,890	79,890	79,890
2.	Z	2	4	2
3.	Kristal Sistem	Tetragonal	Tetragonal	Ortorombik
4.	Nokta Grubu	4/mmm	4/mmm	Mmm
5.	Uzay Grubu	P4 ₂ /mnm	I4 ₁ /amd	Pbca
6.	Birim Hücre			
	A (A°)	4,5845	3,7842	9,184
	B (A°)			5,447
	C (A°)	2,9533	9,5146	5,145
	Hacim	62,07	136,25	257,38
7.	Molar Hacim	18,693	20,156	19,377
8.	Yoğunluk	4,2743	3,895	4,123
9.	Yasak Enerji Aralığı	3,0 eV	3,2 eV	3,4-3,55 eV
10.	Kırılma İndisi	2,7	2 - 2,4	2-2,4
11.	Dielektrik Sabiti	110-117	48	78

Çizelge 1.1. TiO₂'in yapısal özellikleri (Mo and Ching 1995, Cromer and Herrington 1955)



Şekil 1.1. TiO2'in üç fazının kristal yapısı

Brukit yapısı adını mineralojist H.J. Brooke'den almıştır. Brukit laboratuvar ortamında sentezi oldukça zor doğal fazdır. Doğada anataz ve rutileden daha nadir bulunur ve TiO₂'nin diğer iki kristal yapısından daha kompleks yapıya sahiptir. Ortorombik yapıya sahip 8 formül birimi içeren bir elementel hücre tarafından oluşur. Brukit sarıdan kahvekırmızıya değişen oldukça farklı renklere sahip düz, küçük, borumsu kristallerden oluşmaktadır. Bu polikristal basınç ve sıcaklık uygulanmadığında kararlı yapıya sahiptir. Basınç ve sıcaklık uygulandığında anataz ve rutile fazına dönüşür (Kandiel *et al.* 2010).

Rutile ismi Latince rutilus (kırmızı) kelimesinden gelmektedir. Rutile doğada TiO₂ mineral formunun en yaygınıdır. Rutile yapısı sıkıştırılamaz, birim hücresi tetragonaldir. Rutile kristalleri doğada saf halde transparandırlar, safsızlıklar olduğunda kırmızı ya da siyah renge dönüşürler. Kristallerinin şekli çok ince iğneli yapıda olduğunda turuncu renkte olabilir. Rutile yüksek termal ve kimyasal kararlılığa sahip olup hava şartlarında yülsetgenmeye karşı dirençlidir. Yüksek kırılma indisinden dolayı kaplamalarda ve beyaz boya pigmenti için daha uygundur (Zhang and Banfield 1998). Bu yüzden rutile fazı TiO₂'in brukit ve anataz fazları arasındaki geçişlerde gerçekleşen proseslerdeki basınç, sıcaklık gibi parametre etkisini daha iyi anlamak için önemlidir. Rutile, anataz ve brukite yapısına göre termodinamik olarak daha kararlıdır (Zhang and Banfield 2000). HF ve H_2SO_4 'te anataz ve brukitten daha az çözünür. Fakat termodinamik kararlılık partikül boyutuna bağlıdır. 14 nm altındaki partikül boyutlarında anataz fazı rutileden daha kararlıdır. Bu anatazın niçin ultra-ince boyutlarda sentezlenebildiğini açıklar. Partikül boyutu küçüldüğünde rutilenin yüzey enerjisi anatazın yüzey enerjisinden düşük olduğu açıklanmıştır. (Finnegan *et al.* 2008). Fotokatalitik çalışmalarda rutile ve anataz fazı oldukça çok kullanılır.

Anataz ismini Yunanca anatasis kelimesinden almaktadır. Rutilenin doğrusal düzenlenmesi ile karşılaştırıldığında anatazın yapısı TiO₆ oktahedranın daha bozuk düzenlenmesi ile rutileden ayrılmaktadır. İki yapının komşu atomlar arasındaki uzaklıkları farklıdır. Ti-Ti arasındaki uzaklık, anataz yapıda rutile yapıdan daha kısa iken, Ti-O arasındaki uzaklık rutile yapıdan daha uzundur. Her iki yapıda da her bir Ti⁺⁴ iyonu, 6 tane O⁻² iyonundan oluşan oktahedron tarafından çevrelenir. Bir oksijen atomu 3 tane titanyum atomu ile bağ kurmuştur yani üç tane oktahedraya aittir. Anatazın rutileden daha yüksek fotokatalitik aktiviteye sahip olduğu düşünülmektedir. Tek kristal halinde anataz büyük bir spesifik yüzey alanına sahip olduğu için yüksek düzeyde fotokatalitik etki gösterir. Bu nedenle diğer kristallere göre daha çok incelenen kristal fazdır (Jin *et al.* 2011). Anataz kristalleri küçüktür ve doğal rengi maviden sarıkahveye değişir (Nolan 2009).

1.1.3. TiO₂'in sentez yöntemleri

 TiO_2 , toz kristaller veya ince filmler şeklinde hazırlanabilir. Hazırlanan malzeme nanometreden birkaç mikrometreye kadar değişen kristallerden oluşturulabilir. Nano boyutlu kristaller yığılma eğilimindedir. Eğer ayrı nanoboyutlarda malzeme sentezlenmek isteniyorsa yığılmanın olmaması istenir. Birçok sentez yöntemi ile yığılma olmaksızın nanopartiküller sentezlenebilir.

 TiO_2 'nin fiziksel ve kimyasal özellikleri TiO_2 sentezi yöntemi için önemli bir parametredir. Temel olarak, gaz fazı yöntemleri ve çözelti yöntemleri olmak üzere iki

farklı hazırlama yöntemi vardır. Gaz fazı yöntemleri arasında başlıca teknikler kimyasal buhar birikimi (CVD), fiziksel buhar çökeltme (PVD) ve sprey piroliz depolaması (SPD)'dır. Çözelti yöntemleri arasında hidrotermal ve solvotermal yöntem, çökeltme yöntemi, mikroemülsiyon yöntemi, yanma sentezi, elektrokimyasal sentez ve sol-jel yöntemi bulunur (Carp *et al.* 2004).

1.1.3.a. Hidrotermal sentez

Hidrotermal terimi genellikle normal şartlar altında nispeten çözünmeyen maddeleri çözmek ve kristallendirmek için yüksek basınç ve sıcaklık altında sulu çözücüler veya mineralleştiricilerin varlığında yapılan heterojen bir reaksiyon olarak tanımlanır. Çeşitli ortamlarda gerçekleşebilir. En çok kullanılan ortam paslanmaz çelik teflon otoklava ait resim Şekil 1.2'de gösterilmiştir.



Şekil 1.2. Otoklav görüntüsü

Rabenau hidrotermal sentezi 1 bar basınç ve 100°C sıcaklık üzerinde sulu ortamda gerçekleştirilen heterojen reaksiyonlar olarak tanımlamıştır (Rabenau 1985). Laudise'e göre hidrotermal sentez çevre veya çevre koşullarına yakın şartlarda sulu çözeltilerden büyümenin gerçekleştiği reaksiyonlardır (Laudise 1970). Roy ise hidrotermal sentezi 1

atm'den daha büyük basıncta oda sıcaklığının üzerinde sulu bir ortamda gerçeklestirilen herhangi bir heterojen reaksiyon olarak tanımlamaktadır (Roy 1994). Sonuç olarak, hidrotermal teknik adı altında; kristal büyümesi, elektrokimyasal reaksiyon, arıtma, değişim, çöktürme, kristallendirme, bozunma, dehidrasyon, ekstraksiyon, reaksiyon sinterleşmesi, mekanik kimyasal reaksiyon ve buna benzer çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Günümüz bilim insanları hidrotermal reaksiyonu kapalı bir sistemde, 1 atmosferden daha büyük bir basınçta ve oda sıcaklığında bir çözücü varlığında (sulu veya susuz) gerçekleşen heterojen bir reaksiyon olarak tanımlamaktadırlar. Sıcaklık suyun kaynama noktasının üzerine çıkabilir ve buhar doygunluğunun basıncına ulaşılabilir. Otoklava eklenen çözelti miktarı ve sıcaklık iç basıncı belirler. Hidrotermal reaksiyonda su genellikle bir katalizör olarak kullanılır. NaOH, KOH, HCl, HNO₃, CH₃COOH ve H₂SO₄ solüsyonları genellikle mineralleştirici olarak kullanılır. Hidrotermal yöntem seramik endüstrisinde küçük partiküllerin üretimi için oldukça yaygındır. TiO₂ nanopartikülleri titanyumun sulu çözeltilerinin hidrotermal olarak işlenmesi ile elde edilebilir. TiO₂ nanopartiküllerinin yanı sıra nanoteller ve nanotüpler de hidrotermal yöntemle sentezlenmiştir (Wanga et al. 2009).

1.1.3.b. Solvotermal sentez

Solvotermal yöntem hidrotermal yönteme benzer ancak bu sentezde su yerine çeşitli çözücüler kullanılır. Bu yöntemde yüksek kaynama noktalı organik çözücüler kullanılması durumunda dar bir aralıkta dağılmış nanopartiküller sentezi mümkün olmaktadır. Solvotermal yöntem nanopartiküllerin şekil dağılımı, boyut büyüklüğü ve kristal oranını hidrotermal yönteme göre daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Literatürde yüzey aktif madde bulunan veya bulunmayan çözeltilerde TiO₂ nanopartikülleri sentezlemek için solvotermal sentez kullanılmıştır.

1.1.3.c. Sol-jel yöntemi

Sol-jel yöntemi solüsyon içeren bir malzemenin jel yapısına dönüştürülmesi esasına dayandığı için sol-jel adını alır. Çeşitli oksit maddelerinin ve seramik malzemelerin çok

yönlü sentezinde kullanılan bir yöntemdir. Sol-jel işlemi sırasında bir kolloid süspansiyon ya da solüsyon genellikle inorganik metal tuzları veya metal alkoksitler gibi metal organik bileşikler öncülüğünde polizmerizasyon reaksiyonları ve hidrolizden oluşur (Fernandez *et al.* 2004). Alkoksitler sol-jel sentezinde en yaygın kullanılan kimyasallardır çünkü zehirli değillerdir. Sol, sıvıdaki kolloidal ve katı parçacıkların veya polimerlerin dengeli bir süspansiyonudur. Parçacıklar amorf ve kristal olabilir. Jel ise sıvı fazı çevreleyen ve destekleyen gözenekli 3 boyutlu sürekli bir katı örgü yapısına sahiptir. Sol-jel işemi kristallenme ile çökelmeden ziyade jelleştirme ile katı ürünlerin elde edilmesini sağlar. Sol-jel yöntemi katının yapısal, kimyasal ve morfolojik özelliklerin kontrol edilmesine izin verir. TiO₂ ince filmini oluşturmada en çok kullanılan yöntemdir ve çeşitli sentez teknikleri sunmaktadır (Şekil 1.3). TiO₂'in sol-jel ile sentezi için TiCl₄, TiCl₃ ve Ti(SO₄)₂ inorganik bileşikleri kullanılmıştır. TiO₂'in farklı kristal yapıları sol-jel yönteminde farklı sıcaklık uygulamaları gerektirir. Anataz fazı yaklaşık 400°C sıcaklıkta elde edilirken, rutile fazının sentezinin 400-1200°C sıcaklıkta oluştuğu bildirilmiştir (Hanaor and Sorrell 2011).

Hidrotermal ve solvotermal yöntemlere göre bu tekniğin avantajları; büyük ölçekli sentez, homojen yüzey elde edilebilmesi, nanokristal malzeme sentezine imkan vermesi, parametrelerinin ayarlanabilir olması (sıcaklık, basınç), çevre dostu, istenilen kalınlıkta film oluşturulması olarak sıralanabilir. Çözücü proseslerine bağlı ürün oluşumu ve çözücü giderme zorluğu bu yöntemin dezavantajıdır (Kolen'ko *et al.* 2005).



Şekil 1.3. Sol-Jel Sentez yöntemleri (Brinker and Scherer 1990)

1.1.3.d. Kimyasal buhar depozisyonu (CVD)

Kimyasal buhar depozisyonu (CVD), en basit haliyle bir substrat üzerinde ince bir tabaka oluşturma yöntemidir. Silindir şeklinde bir kapalı alan içerisinde gazların salınmasıyla ortamda meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu sıcak substrat üzerinde ince film oluşturma metodudur. Reaktif gaz karışımları ve inert gazlar sabit bir akış hızıyla reaksiyon ortamına verilir. Reaktifler bir sınır tabaka yoluyla ortama girer substrat üzerine yayılır ve yüzeyde bir gaz bulutu oluşur, bu gaz bulutu içinde kimyasal reaksiyonlar sonucu yüzey üzerinde kümeleşmeler meydana gelir ve bunlar birleşerek sürekli oluşan bir ince film haline gelir. Oluşan yan ürün gazları ise geri bırakılır ve vakum ile ortamdan uzaklaştırılır (Sayılkan 2007). Yüksek saflıkta ve performansta katı maddeleri üretmek için yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 1000°C) gerçekleştirilir. Depozit malzemenin kalitesi reaksiyon sıcaklığına, reaksiyon hızına ve reaktantların konsantrasyonuna bağlıdır. Bu tekniğin avantajı nanoparçacıkların ve nanofilmlerin homojen bir şekilde kaplanmasıdır. Bununla beraber bu işlemde gerekli olan yüksek sıcaklıkların sınırlamaları vardır ve ölçeklendirmek zordur (Kim *et al.* 2004). Vakumda

buharlaştırma yönteminden farklı olarak buhar oluşturmak için dışarıdan ısı verilmez. CVD çeşitli metaller ve metal oksitler olmak üzere geniş bir yelpazede malzeme biriktirmek için kullanılan yöntemdir. Mikroelektronik ve cam endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Bu işlem normalde çeşitli yüzeylerin mekanik, elektriksel, termal, optik, korozyon direnci ve aşınma direnci özelliklerini değiştirmek için kaplamalarda kullanılan tekniktir. CVD işlem basamakları Şekil 1.4'te gösterilmiştir.



Şekil 1.4. CVD işlem basamakları

CVD tekniğinin kullanılan araçlara göre farklı çeşitleri vardır. Sıcaklıkla uygulanan iki CVD tekniği buharın fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılan çalışma basıncına bağlı aerosol yardımlı CVD (AACVD) ve atmosferik basınçlı CVD (APCVD) yöntemleridir. APCVD işlemi 1 dakika süre içerisinde 200nm-4µm aralığı oranında çok hızlı ve kontrolsüz film büyümesi sağlar. AACVD, APCVD tekniğine benzerdir, fakat vektörel bir hareket için ultrasonik oluşturulan aerosol kullanılır. Büyüme oranları genellikle APCVD'ye göre daha düşüktür. Gaz fazında çeşitli çözücüleri le farklı tepki verebileceğinden reaktant sıklıkla üretilecek malzemeye karışır. Bu farklı ara ürünlerin oluşumuna ve dolayısıyla TiO₂'in farklı kristalografik fazına yol açabilir (Edusi *et al.* 2012).

1.1.3.e. Sonokimyasal ve mikrodalga sentez

Ultrason yüksek yüzey alanlı geçiş metalleri, alaşımlar, karbürler, oksitler ve kolloidler içeren nanoyapılı materyallerin sentezinde oldukça yaygın kullanılır. Sentezlenmek istenen malzemenin çözelti ortamında kuvvetlice karıştırılması, maddenin çözünmesi, radyasyona tabi tutulması, santrifüjlenmesi ve yıkanıp kurulması esaslarına dayanır (Arami *et al.* 2007). Ultrasonun kimyasal etkileri sadece molekül türlerinin etkileşiminden gelmez. Bir sıvıda kabarcıkların oluşması, büyümesi, patlaması ve çökmesi anlamına gelen sonokimyasal akustik kavitasyondan kaynaklanır. Zhu ve arkadaşları sonikasyon tekniği ile titanya nanotüplerini geliştirmişlerdir (Zhu *et al.* 2001).

Mikrodalga ile desteklenen sentezlerde bir mikrodalga sistemi kullanılır. Bu sistemlerde kullanılan mikrodalgaların frekansı 900-2450 MHz'dir. Hem sıcaklık hem basınç tarafından kontrol edilir. Literatürdeki verilere göre mikrodalga sentezler 194°C'de 5 dk⁻¹ ile saat içeren değişik zamanlarda yapılmıştır (Komarneni *et al.* 1999). Zaman, basınç, sıcaklık ve güç bilgisayar sistemiyle kontrol edilir. Wu ve arkadaşları rutile, anataz ya da karışık fazda TiO₂ kristallerini NaOH sulu çözeltisinde belirlli bir mikrodalga gücü altında reaksiyona sokarak TiO₂ nanotüplerini sentezlemişlerdir (Wu *et al.* 2005).

1.1.3.f. Elektrokimyasal sentez

İnorganik katıların sentezinde difüzyon engeli problemi yaşanmakta ve bu engeli aşmak için partikül boyutlarının küçültülmesi veya düşük sıcaklık uygulaması avantaj sağlamaktadır. Çözelti içerisinde dağılmış türlerin elektrostatik yüklenmesi ve difüzyon ortamının gözenekli, katmanlı veya kusurlu olması durumunda uygulanabilecek alternatif strateji, bir elektrik potansiyeli uygulamaktır. Mevcut sentez teknikleri arasında olan elektrosentez yöntemi; oksit bazlı elektroniklerin geliştirilmesi ve nanometreden mikrometreye kadar değişen kalınlıkta filmlerin imalatı için çok iyi sonuçlar göstermektedir. Ayrıca oda sıcaklığında istenilen ürünün sentezi mümkündür. Bu yüzden elektrokimyasal depozisyon yöntemi ince film oluşturma teknikleri arasında en çok tercih edilen tekniktir.

Elektrokimyasal sentez, bir elektrolit içerisinde iki veya daha fazla elektrot arasından elektrik akımı geçişine dayanır. Elektrokimyasal tepkime elektrot-elektrolit arayüzünde gerçekleşir. Elektrosentezi diğer sentez metodlarından ayıran birkaç özellik aşağıda listelenmiştir:

1) Elektrokimyasal sentez, elektrodun yakınında 10⁵ V/cm'lik çok yüksek bir potansiyel gradiyentine sahip olan elektriksel çift tabakada gerçekleşir. Bu koşullar altında meydana gelen reaksiyonlar sonucu çoğu zaman bir kimyasal sentezde elde edilemeyen ürünler elde edilebilir.

2) Ürün, elektrot üzerine ince bir film veya tabaka formunda depozit edilir.

3) Elektrokimyasal sentezde kullanılan elektrolitin kaynama noktası sıcaklığına kadar çalışma imkanı vardır ve hem çalışma sıcaklığını yükseltmek hem de iletkenliği arttırmak için elektrolitlerin içerisine tuz ilave edilebilir.

4) Hücreden geçen akım kontrol edilerek kinetik kontrol sağlanırken; uygulanan hücre potansiyelini değiştirilerek termodinamik kontrol gerçekleştirilebilir.

5) Elektrokimyasal sentez indirgenme ya da yükseltgenme reaksiyonu sonucunda gerçekleşir. Uygulanan hücre potansiyeli ayarlanarak, oksitleyici veya indirgeyici reaksiyonlar değiştirilebilir. Bu özellik elektrokimyasal sentezi kimyasal sentezden daha avantajlı kılar.

6) Depozit edilen malzeme kompozisyonu çözeltinin bileşimi çeşitlendirilerek kontrol edilebilir.

7) Deneylerin uygulanması basittir, aletler ekonomiktir ve kolaylıkla kullanılabilir.

Fakat elektrosentez yönteminde ortam sıcaklığına bağlılıktan kaynaklı amorf film eldesi ve yapısal karakterizasyonu zor düzgün olmayan ürün oluşumu gibi bazı dezavantajlar vardır.

Elektrokimyasal sentez başarısı birçok reaksiyon parametresinin doğru seçilmesine bağlıdır. Bu parametreler:

- Elektrodun inert ya da reaktif olması.
- Elektrolit seçimi.
- Sıcaklık, pH ve konsantrasyon seçimi.
- Bölünmüş veya bölünmemiş hücre sistemi
- Potansiyostatik veya galvanostatik elektroliz tekniğidir (Therese and Kamath 2000).

Elektrokimyasal depozisyon anodik ve katodik olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Katodik depozisyon sentezi genelde katotta indirgeme ile yüzeye metalik bir kaplama oluşturmak için kullanılır. Kaplanacak malzeme katot görevi yapar ve kaplanması istenen malzemenin tuzunu içeren bir çözeltiye daldırılır. Metalik iyonlar katotta metalik forma indirgenir. Katodik depozisyon yönteminde TiO₂ oluşumu titanyum oksihidroksit (TiO(OH)₂) üzerinden gerçekleşir. TiO(OH)₂ ısıl işleme tabi tutulduğunda kolaylıkla TiO₂ yapısına dönüşür.

$$\operatorname{Ti}^{4+} + 4\operatorname{OH}^{-} \xrightarrow{\mathfrak{lsl}} \operatorname{Ti}(\operatorname{OH})_{4} \to \operatorname{TiO}_{2}$$
 (1.1)

Katodik depozisyonun avantajı doğrudan elektrot yüzeyinde, yapı kusurları daha az ve pürüzsüz nanoyapıların oluşmasına imkân verir (Maijenburg *et al.* 2014).

Anodizasyon metal yüzeyinde koruyucu oksit oluşturulan elektrolitik işlemdir. HF temelli sulu çözeltilerde TiO_2 'in anodik sentezi oldukça yaygındır. 1984 yılında ilk Ti oksidasyonu raporları vardır. TiO_2 nanoyapıları (nanotel ve nanotüp) anodizasyon altında oksidant kullanarak Ti metalinin oksidasyonu ile elde edilebilir (Ryu *et al.* 2008). Kristal TiO_2 nanotelleri H_2O_2 ile Ti metalinin doğrudan oksidasyonu ile elde edilebilir (TiO_2 kristal formunda bozulma olabilir. İnorganik tuzların eklenmesi ile TiO_2 kristal fazı kontrol edilebilir. Anodik oksidasyon yönteminde Ti levha elektrota

15-20 V arası potansiyel uygulandığında Ti elektrot yüzeyinde büyük ölçekli tek kristal yapıda Ti nanotüpler oluşur. Ancak bu yöntemin dezavantajı oluşan nanotüpler iletken bir geri elektrot malzemesi içermez ve uygulamalarda kullanılmadan önce ekstra basamaklara gereksinim duyar (Hayakawa *et al.* 2002).

Proses parametrelerine bağlı olarak Ti yüzeyinin anotlanması kompakt, rastgele veya düzenlenmiş gözenekli ve boru şeklinde TiO₂ üretmeye neden olabilir. Ti metalinden anodizasyon yöntemi ile TiO₂ sentezi için genel reaksiyon aşağıdaki gibidir:

$$Ti + 2H_2O \rightarrow TiO_2 + 4H^+ + 4e^-$$
(1.2)

TiO₂ nanomalzemesinin büyümesini etkileyen faktörler; elektrolitin pH'sı, sıcaklık, konsantrasyon, anodizasyon potansiyeli, akım yoğunluğu ve anodizasyon zamanı olarak sıralanabilir. Sonrasında oluşan malzemenin ısı ile muamelesi yapının özelliklerini ve kristallerini kontrol etmek için gerçekleştirilir (Robin *et al.* 2014). TiO₂ nanoyapılarının uygulama etkinliği tabakaların geometrisine ve yüzey alanına bağlı olduğu için TiO₂ nanoyapılarının anodik büyümesi önemli ilgi görmüştür. Bu bağlamda nanoyapıların çapı, uzunluğu, en/boy oranı nanoölçekli cihazların hassasiyetini ve seçiciliğini etkilemektedir (Kulkarni *et al.* 2016).

1.4. TiO₂-Grafen nanokompozitler

Gelişen teknoloji daha iyi yüzey özelliklerine sahip malzeme gereksinimini arttırmıştır. Metaller en iyi iletken malzemelerdir ancak yüksek ağırlık ve şekil verememe gibi dezavantajları vardır. Bu problemi çözebilmek için iletkenliği yüksek malzemeli kompozitlerin üretilmesi düşünülmüştür. Metal alaşımların aksine kompozit malzemede her bileşen kendi kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini muhafaza eder.

En az iki farklı makro seviyede ve birbiri içinde çözünmeyecek şekilde bir araya gelen malzemelere kompozit malzeme denir. Malzemelere kazandırdığı iyi ve yeni özelliklerden dolayı nanoteknoloji kompozit uygulamalarını yaygın olarak kullanmaya başlamıştır. Parçacık boyutunun küçülmesi ile erime ve kaynama noktası gibi temel fiziksel özellikler değişime uğramakta ve oluşan nanoparçacıkların özgün (ısıl, elektromanyetik, optik ve mekanik) özellikleri boyut etkisine bağlı olarak oluşmaktadır. Nanoparçacık kullanarak malzemenin özelliklerini geliştirmenin en iyi yolu, özellikleri kontrol edilebilen çeşitli bileşimlere sahip kompozit yapılar oluşturmaktır (Maeda 1992).

Nanokompozitler en az iki farklı fazdan meydana gelen ve bu fazlardan en az birinin 100 nm'nin altında olduğu malzemelerdir. Nanokompozitler küçük boyutlarından dolayı yüksek yüzey alanı/hacim oranına sahiptirler ve kompozit malzemelerden daha iyi özellikler gösterirler ve tanecik, tabaka veya lif takviyeli olarak üretilmektedirler. Nanokompozitler dolgu ve matris olarak bilinen iki temel bileşenden oluşur. Genelde dolgu maddeleri nanoboyuttadır. Matrisler ise nanodolgunun yerleşik olarak tutulduğu yapılardır (Ajayan *et al.* 2003).

 TiO_2 , yüksek kararlılık, düşük maliyet, nispeten düşük toksik özellik ve diğer yarıiletken malzemelerle karşılaştırıldığında mükemmel fotokatalitik performans nedeniyle standart bir fotokataliz olarak geniş ölçüde kullanılmıştır. Bununla birlikte, TiO_2 kullanımının dezavantajı dünya güneş spektrumunun görünür aralığında sınırlı bir fotoaktiflik sunmasıdır. Bu bağlamda, tipik fotokatalizlerden yüksek fotoaktivite üretmek için diğer materyaller ile kompozit oluşturulmuş veya metal partiküllerinin depozisyonu ile modifiye edilmiştir.

TiO₂ ile kompozitler hazırlamak için seçilebilen farklı malzemeler arasında, karbon materyalleri hem asit hem de bazik ortamda kimyasal inertlik ve stabilite, ayarlanabilir yapısal ve kimyasal özellikler gibi benzersiz avantajlar sunar (Morales *et al.* 2012). Özellikle, bal peteği yapısına benzer, sp² karbon bağlarına sahip 2 boyutlu tek tabaka olan grafen, yük taşıyıcılarının mükemmel hareket kabiliyetine, geniş spesifik yüzey alanına, esnek yapıya, yüksek şeffaflığa ve iyi elektriksel ve termal iletkenliğe sahip olması nedeniyle, yeni nesil fotokatalizörlerde en umut verici malzemelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Grafeni sentezlemek için birçok yöntem kullanılmıştır ve grafitin

oksidasyonuyla grafit oksidin (GO) indirgenmesinden oluşan yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır (Lambert *et al.* 2009).



Şekil 1.5. Grafen-TiO₂ nanokompozit oluşumu (Wang *et al.* 2009)

Grafitin kuvvetli kimyasal oksidasyonu ile Hummers ve Offeman (1958) tarafından geliştirilen metod kullanılarak GO hazırlanabilir ve ardından elde edilen GO'in sonikasyon yardımıyla eksfoliyasyonuyla GO tabakaları birbirinden uzaklaştırılabilir. Bu nedenle büyük ölçekli GO'in indirgenmesi ile grafen sentezinde bu yöntem güvenilirdir ve literatürde de oldukça sık kullanılmaktadır (Morales *et al.* 2012).

1.5. TiO₂-Grafen nanokompozitlerinin uygulama alanları

Son zamanlarda suyun parçalanması ile hidrojen üretimi, hava ve suyun dezenfeksiyonu, solar uygulamalar için fotokatalitik reaktör tasarımı ve etkili fotokataliz üretimi gibi uygulamalara ilgi bilimsel anlamda artmaktadır. TiO₂-grafen nanokompozitleri güneş pilleri, lityum iyon pilleri, sensörler, CO₂'nin fotokatalitik indirgenmesi, kendi kendini temizleme özelliğine sahip yüzeylerin geliştirilmesi ve antibakteriyel/anti-kanser aktiviteleri gibi uygulamaları da artmaktadır.

 TiO_2 -grafen nanokompozitlerin oldukça iletken, şeffaf ve fotokatalitik aktiviteleri oldukça yüksek olduğu ve kompozitlerin saf bir TiO_2 filmi ile karşılaştırıldığında ışık

altında kısa sürede süper hidrofiliklik gösterdiği literatürde belirtilmiştir. TiO₂-grafen nanokompozit ince filminin elektriksel iletkenliği, kirletici partiküllere karşı çürümeyi önleyerek kendi kendini temizleme işlemine katkıda bulunduğu rapor edilmiş ve pahalı metaller yerine (Pt, Pd) düşük maliyetli bir ortak katalizör olarak grafenin yeteneğini ortaya koymuştur. Bu çalışma TiO₂-grafen nanokompozitlerin şeffaf, kendi kendini temizleyen kaplamaların uygulanmasına yönelik kapasitesini göstermekte ve özellikle çeşitli iç mekân uygulamalarında kullanabilirliğini sunmaktadır (Anandan *et al.* 2012).

Güneş enerjisini kullanarak sera gazlarını yararlı kimyasal yakıtlara dönüştürmek için CO_2 'in fotokatalitik indirgenmesi oldukça önemlidir. Ti O_2 -grafen nanokompozitleri fotokatalizasyon uygulamalarında görünür ışık altında tek başına Ti O_2 'e kıyasla yaklaşık yedi kat daha iyi fotoaktivite sergilediği bildirilmiştir (Liang *et al.* 2011).

Elektrokimyasal enerji depolama, rüzgâr ve güneş kaynaklı enerji sistemlerinde, elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerji sistemlerinde ve potansiyel uygulamalar da büyük ilgi görmektedir. Grafen iyi bir elektrik depolayıcı olduğu için şarj ömrünü yüksek derecede uzatabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda TiO₂ Li iyon pillerindeki uygulamasında Li'un elektrokimyasal depozisyonunda yapısal olarak kararlıdır. Grafenin ve TiO₂'nin sahip oldukları özellikleri kompozit içerisinde de koruması ile grafen-TiO₂ nanokompozitler Li-iyon pillerinde yüksek tersinirlik ve öz kapasitesi sergilemektedirler. TiO₂ nanopartikülleri Li₂O üzerine homojen bir şekilde dağılmış haldedir. Nanokompozit Li iyonlarının redoks reaksiyonu esnasında metalin hem iyonik hem de metalik durumlarında giriş/çıkış yapmasını kolaylaştırarak daha yüksek kapasite sergilemesini sağlar. Nanokompozit malzemenin şarj kapasitesi, saf TiO₂ fazına kıyasla, iki katından fazla artmıştır (Wang *et al.* 2009).

Boya duyarlılaştırılmış güneş pilleri (DSSC'ler) foto-anotları düşük maliyetli, basit proses ve büyük ölçekli üretim gibi avantajlara sahip oldukları için, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmede umut verici bir teknolojidir. DSSC'lerin foto-anotları tipik bir mezo-gözenekli ağa sinterlenmiş ince TiO₂ nanopartiküllerinin kalın filmleri kullanılarak oluşturulmaktadır. Kalın nanopartikül film yeterli boya moleküllerini tutmak için genis bir yüzey alanı sağlar. Bununla birlikte, düzensiz TiO₂ nanopartiküllerindeki elektron taşınımı olayı, elektronların elektrot yüzeyine ulaşmadan önce çok sayıda kolloidal parçacıklar içerisine sınırlı difüzyon işlemi sayesinde ilerlemektedir. Fotojenleştirilmiş elektronlar için böyle rasgele bir geçiş yolu, taşıyıcı rekombinasyon sansını arttırır ve böylece DSSC'lerin etkinliğini azaltır. Fotojenerasyonlu taşıyıcılarda oluşturulan elektronların, elektroda iletilme yollarının geliştirilmesi, güç dönüştürme verimliliğini önemli ölçüde artıracağı düşünülmektedir. Güneş pillerindeki bu elektron taşınmasını hızlandırmak için bazı araştırma grupları TiO₂ grafen kompozitlerini üretmişler ve DSSC uygulamarındaki verimini araştırmışlardır (Tang et al. 2010).

Literatürde TiO₂-grafen nanokopozitlerinin bir uygulaması olarak fotokatalitik bakteri dezenfeksiyonu incelenmiştir. Güneş ışığı altında sulu bir solüsyonda E. coli bakterilerinin parçalanması için yapılan bir çalışmada; farklı ışınlama sürelerinde, 4 saat boyunca fotokatalitik olarak bakteriler indirgenmiştir. İndirgenme esnasında TiO₂ üzerine biriktirilen grafen tabakası, TiO₂ ince filminin antibakteriyel aktivitesinin yaklaşık 7,5 kat yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca grafen tabakaları bakterilerin foto-aktifleştirilmesinden sonra kimyasal olarak da oldukça kararlıdır (Akhavan and Ghaderi 2009).

TiO₂-grafen kompozitleri literatürde çoğunlukla fotokatalitik özellik incelemelerinde kullanılmışlardır. Bu tez kapsamında TiO₂ ince filmlerinin elektrokimyasal olarak sentezi ve karakterizasyonu yapılacaktır. Sonrasında TiO₂-elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit (ERGO) kompozitleri tek aşamalı elektrokimyasal yöntem kullanılarak sentezlenecektir.

2. KAYNAK ÖZETLERİ

2.1. TiO₂'in Elektrokimyasal Sentezi

Tipik bir elektrosentezde, elektrolit içerisinde çözünen reaktif, katı bir ürün olarak depozit edilir. Depozisyon akımı ve hücre potansiyeli reaksiyonun gidişatını belirleyen iki önemli parametredir. Bu parametrelerden herhangi biri, reaksiyon sırasında zamanın bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. Depozisyon potansiyelinin indirgenme veya yükseltgenme oluşturacak şekilde uygulanmasına bağlı olarak elektrodepozisyon anodik ve katodik olmak üzere ikiye ayrılır.

Anodik depozisyon tekniğinde, daha düşük bir oksidasyon derecesinde olan bir metal iyonu, anodik olarak daha yüksek bir oksidasyon derecesine yükseltilmektedir. Elektrolitin pH değeri metal iyonunun oksidasyon derecesine bağlı olarak kararlı yapıda olmasına ve yüksek oksidasyon derecelerinde metal oksit/hidroksit verecek şekilde hidrolize uğramasına sebep olur.

$$M^{z+} \to M^{(z+\Delta)+} + \Delta e^{-}$$
(2.1)

$$M^{(z+\Delta)+} + (z+\Delta) OH^{-} \rightarrow M(OH)_{z+\Delta} \rightarrow MO_{(z+\Delta)/2} + (z+\Delta)/2 H_2O$$
(2.2)

Ayrıca bu teknik kullanılarak Pb^{2+} ve Mn^{2+} iyonlarını içeren çözeltilerin anodik oksidasyonu ile PbO_2 ve MnO_2 elektrotlarının fabrikasyonu gerçekleştirilmiştir. Elektrosentez ile sentezlenen yarı-kararlı PbO_2 ve MnO_2 oksitleri kimyasal sentezle elde edilen diğer polimorfik modifikasyonlara kıyasla daha yüksek bir elektrokimyasal aktivite sergilemiştir (Therese and Kamath 2000).

Oliveira vd (2016) yaptıkları çalışmada TiO₂ filmlerini anodik depozisyon yöntemiyle sentezlemişlerdir. TiO₂ filminin elektrokimyasal depozisyonu için çalışma elektrodu olarak 30 cm²'lik geometrik alana sahip 2 mm kalınlığında saf Ti levhası kullanılmıştır.

Ti levha yüzeyi, 360-2000 gritli bir SiC kağıdı ile zımparalanmış, asetonla yıkanmış, 20 dakika boyunca izopropil alkol içerisinde ultrasonik olarak temizlenmiş ve daha sonra kullanılıncaya kadar izopropil alkol içerisinde korunmuştur. Ti-levhanın ucuna platin tel bağlanarak elektriksel bağlantı sağlanmıştır. Üç elektrotlu bir hücrede karşıt elektrot olarak platin folyosu (30 cm²) ve referans olarak bir Ag/AgCl elektrot kullanılmıştır. Elektrokimyasal deneylerde destek elektroliti olarak pH 9,0 fosfat tamponu seçilmiştir. Voltametri deneyleri, 50 mV s⁻¹'lik tarama hızında -1,0 ve -5,0 V potansiyel aralıkta gerçekleştirilmiştir. Bu ortamda Ti levha elektrot ile alınan voltamogram Şekil 2.1'de verilmiştir.



Şekil 2.1. Ti levha elektrotta TiO_2 'nin anodik depozisyonuna ait dönüşümlü voltamogramı (Oliveria *et al.* 2016)

Şekil 2.1'de alınan dönüşümlü voltamogramda -1.0 ile +5.0 V potansiyeller arasında tarama gerçekleştirilmiştir. 0,89 V ve 2,24 V merkezli anodik pikler TiO_2 oluşumuna aittir. Anodik oksidasyon işlemi sırasında metalik Ti levhasının çözünmesini engellemek amacıyla oksit tabakası oluşturulmuştur. Artan çevrim sayılarında, ilk taramadan sonra Ti yüzeyinin şarj transfer direncini arttıran oksit tabaka tarafından elektrot yüzeyi pasifleşir ve akım önemli ölçüde azalır (Oliveira *et al.* 2016).

Ti metalinin anodik oksidasyonu sonucu TiO_2 nanotüpleri elde edilmektedir. Elde edilen TiO_2 nanotüpleri yüksek yüzey alanı, termal kararlılık, kontrollü gözenek yapısı ve nispeten düşük sentez maliyetine sahiptir. Ti metali iki elektrotlu hücre sistemi kullanılarak oda sıcaklığında kütlece %2,5'lik su ve %0,5'lik amonyumflorit içeren etilenglikolde 2 saat boyunca 30 V'ta anodize edilmiş ve anodize ürün 450°C'de 2 saat tavlanarak anataz formundaki TiO₂ nanotüplerine dönüştürülmüştür (Gobal and Faraji 2015).



Şekil 2.2. Ti elektrot yüzeyinde anodik depozit edilmiş TiO₂ nanotüplerinin SEM görüntüsü (Gobal and Faraji 2015)

Metal tuzlarını içeren çözeltiden elektrik akımı geçirildiğinde, metal iyonları katot elektrotta birikir. Katodik depozisyon yöntemi ile güneş pilleri ve fotovoltaik uygulamalar için TiO₂ yapılarının farklı substrat yüzeylerinde biriktirilmesi sağlanabilir bu amaçla TiO₂ ve çinko oksit (ZnO) ince filmlerinin katodik elektrodepozisyonu araştırılmıştır. Literatürde yapılan çalışmalarda ZnO ve TiO₂'in yanı sıra katodik depozisyon Ni(OH)₂, Co(OH)₂, SnO₂ gibi birkaç geçiş metal oksiti hazırlamak için de kullanılmıştır. Genel olarak metal oksit oluşumuna ait reaksiyon basitçe aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^- \tag{2.3}$$

$$NO_3^{-} + 6H_2O + 8e^{-} \rightarrow NH_3 + 9OH^{-}$$

$$(2.4)$$

$$M^{n+} + nOH^{-} \rightarrow Metal hidroksit \xrightarrow{dehidratasyon} Metal oksit + H_2O$$
 (2.5)

Katot elektrodunun yakınındaki OH⁻ oluşumundan dolayı alt tabakaya metal hidroksitler çöker ve bu basamak metal oksit hazırlanmasında anahtar adımdır. Çökeltiden dehidratasyon aracılığıyla okso bağları oluşur, bu bağlar sonrasında oksit formuna dönüşür. Yukarıdaki fikri temel alan birkaç araştırmacı, OH kaynağı olarak NO3 ve suyu kullanarak TiO2'nin katodik biriktirilmesini araştırmışlardır. Fakat depozisyon çözeltisini hazırlamak nispeten komplekstir ve işlemler karmaşık adımlar içerir. Örneğin; Zhitomirsky TiO₂'in katodik sentezini TiCl₄ ve H₂O₂ içeren bir solüsyonda gerçekleştirirken, Karuppuchamy ve ark. TiOSO₄, H₂O₂ ve KNO₃ içeren bir depozisyon ortamı kullanmışlardır. Peiro ve ark. amorf Ti(IV)-perokso kompleksinin katodik depozisyonunu ve süspanse nanokristalin P25 TiO2 tozlarının elektroforetik depolanmasını bildirmiştir. Dziewonski ve Grzeszczuk ise dönüşümlü voltametri yöntemiyle seçilen kompleks Ti(IV) ortamından TiO₂ filmlerini hazırlamışlardır. Ayrıca, bu grup gözenekli anataz-TiO₂ filminin katodik depolanması için yeni ve basit bir çözüm olarak TiCl₃ ve NaNO₃ içeren çözelti ortamında depozisyon yapmışlardır. Bu elektrolit ortamından elde edilen TiO₂ filmi önceki raporlarda önerilenlere kıyasla çok daha hızlı bir depozisyon oranı göstermiştir. Bu durumun sebebi olarak; TiO2'in elektrokatalitik etkinlik göstermesi ile katot yakınındaki NO3-'ın OH- üretiminde daha fazla aktivite sergilemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Huang et al. 2010).

TiCl₃ tuzu kullanılarak literatürde porlu TiO₂ filmlerinin katodik depozisyonu için yapılan bir çalışmada TiCl₃ ile NO₃⁻ iyonlarının Ti(IV) ve NO₂⁻'i oluşturmak için redoks reaksiyonuna girdikleri tespit edilmiştir (Şekil 2.3). Bu redoks reksiyonu TiO₂'in katodik depozisyonu için önemli adımı oluşturmaktadır. NO₂⁻'nin N₂'ye ve NH₃'e sürekli indirgenmesi, TiO₂'nin depozisyon oranını arttıran OH⁻ iyonlarını üretmektedir. Hu ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları çalışmada titanya partikülleri grafit substrat üzerine
0.47 M HCl, 25 mM TiCl₃ ve 75 mM NaNO₃ içeren depozisyon çözeltisi içerisinde üç elektrotlu hücre sistemi kullanılarak katodik olarak depozit edilmiştir. Katodik depozisyon 50 mV/s'lik tarama hızında 0,63 V ve -1,2 V potansiyel aralığında 20 çevrim olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen elektrotlar hava ortamında 400°C'de 1 saat süreyle tavlanmıştır.



Şekil 2.3. TiCl₃ ve NaNO₃ çözelti karışımlarının fotoğrafları (A) TiCl₃ (B) 25 mM TiCl₃ ve 75 mM NaNO₃ karışım çözelti (C) 10. s'de karışım çözeltisinde meydana gelen değişim (D) Karışım çözeltisinin 40. S (Hu *et al.* 2009).

Şekil 2.3, depozisyon çözeltisinin hazırlanması sırasında TiCl₃ ve NO₃ arasındaki redoks reaksiyonunu göstermektedir. Bir oksitleyici gibi davranan NO₃, transparan NaNO₃ çözeltisine (Şekil 2.3.B) mor TiCl₃ çözeltisi (Şekil 2.3.A) eklendiğinde NO₂ (baloncuk görünen Şekil 2.3C)'ye indirgenmiştir. NO₂ molekülleri sulu ortamda çözülebilir oldukları için otomatik olarak NO₃⁻ ve NO₂⁻ iyonlarına dönüşmektedir. Bu dönüşüm sonucunda kabarcıklar 30-40 s içinde kademeli olarak kaybolur. Eş zamanlı olarak Ti³⁺¹ün varlığını gösteren mor TiCl₃ çözeltisinin renginin şeffaf hale gelmesi TiO²⁺ iyonlarının oluştuğu anlamına gelir. Gerçekleşen reaksiyonlar aşağıdaki gibidir: (Hu *et al.* 2009).

$$\mathrm{Ti}^{+3} + \mathrm{NO}_{3}^{-} \to \mathrm{Ti}\mathrm{O}^{+2} + \mathrm{NO}_{2}$$

$$(2.6)$$

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2 \tag{2.7}$$

Huang ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; TiCl₃ içeren çözelti ortamına eklenen NO_3^- iyonlarının etkisi voltametrik olarak doğrusal taramalı voltametri (LSV) tekniği ile incelenmiştir (Şekil 2.4). Ti ve TiO₂/Ti elektrotlarda alınan voltamogramlarda sadece HCl ortamında hidrojen çıkış reaksiyonu gözlenmiştir. Güçlü asidik ortamda Ti elektrotta yaklaşık -0,9 V'ta gözlenen H₂ çıkışı TiO₂/Ti elektrotta -0,7 V'a kadar kaymıştır (1 ve 4 numaralı eğriler). HCl çözeltisine TiCl₃ ilave edildiğinde katodik akım dikkati çeker bir şekilde negatife kaymış (2 ve 5 numaralı eğriler), aynı ortama NO_3^- iyonları ilave edildiğinde NO_3^- indirgenme reaksiyonu H₂ çıkış reaksiyonu ile yarışmıştır (3 ve 6 numaralı eğriler).



Şekil 2.4. 0,47M HCl (1,4), 25mM TiCl₃ + 0,47M HCl (2,5), ve 25mM TiCl₃ + 0,47M HCl + 75mM NaNO₃ (3,6) elektrolitlerinde (1-3) Ti ve (4-6) TiO₂/Ti elektrotlara ait 5 mV.s⁻¹ tarama hızında ve 25°C'de alınan doğrusal tarama voltamogramları (Huhang *et al.* 2010)

Titanyum tuzlarının çözünürlüğünden dolayı depozisyon çözeltisi hazırlanırken asidik pH (1-3) aralığı seçilmelidir. pH ayarlaması ve elektrolit ortamı sağlamak için H₂O₂,

KNO₃ ve HNO₃'e ihtiyaç vardır. H_2O_2 titanyum tuzunun oksidasyonunu sağlar, NO₃⁻ ise çözeltide hidroksit (OH⁻) iyonlarını oluşturacak şekilde indirgenir. Depozisyonda kullanılan Ti çözeltisini hazırlamak oldukça sıkıcı ve zaman alıcıdır. Literatürde çözelti hazırlanması kolaylaştırılarak porlu anataz TiO₂ ince film elde edilmiştir, fakat katodik elektroliz yapılırken Ti hidroksit jel filmi oluşumundan dolayı TiO₂'in kristalleştirilmesi için ısı muamelesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Titanyum tuzunun depozisyonu sırasında ortamda bulunması gereken H₂O₂, Ti⁴⁺ iyonları ile kuvvetli bir şekilde etkileşime girdiğine ve böylece bir Ti-peroksi bileşiği oluşturduğuna inanılmaktadır. TiO₂ ince filmleri sulu perokso-titanyum çözeltisinde hazırlandığında numunede Ti-O bağları, perokso grupları ve OH gruplarının varlığı bu etkileşimi desteklemiştir. Isı uygulandığında perokso gruplarının etkileşiminde meydana gelen değişiklikler FTIR spektrumu ile karakterize edilmiştir (Şekil 2.5) 200°C'de tavlanmış numune için alınan FTIR spektrumunda perokso gruplarına ait omuzun zayıflamış olması tavlama ile perokso grubunun bozunuma uğradığını ortaya koymaktadır. Numune 300°C'de tavlandıktan sonra adsorblanmış suyu ifade eden pikler neredeyse kaybolmuş fakat hidroksil gruplarının piki halen 3400 cm⁻¹'de görülmektedir. 300°C'den daha yüksek sıcaklıklarda tavlanmış numunelerde perokso grubu ve adsorbe suyu ifade eden pikler görülmemektedir. Bu sonuç tavlama işlemiyle perokso grubunun tamamen ayrıldığını ispatlamaktadır (Karuppuchamy *et al.* 2007).



Şekil 2.5. Tavlanmamış (a), 200°C'de (b) ve 500°C'de (c) 1saat tavlanmış numunelere ait FTIR spektrumları (Karuppuchamy *et al.* 2007)

TiO₂ ince filmlerinin TiOSO₄ tuzunu içeren elektrolitlerden katodik elektrodepozisyonu ilk olarak Natarajan ve Nogami tarafından ortaya konulmuş, sonrasında Karuppuchamy ve ark. tarafından daha da geliştirilmiştir. Bu yöntem titanyum oksisülfatın (TiOSO₄) tuzunun hidrojen peroksit (H₂O₂) sulu çözeltisinde çözünmesi ve bunun sonucunda bir peroksotitanat Ti(O₂)SO₄ kompleksinin oluşmasına dayanır; (Maijenburg *et al.* 2014).

$$TiOSO_4 + H_2O_2 \rightarrow Ti(O_2)SO_4 + H_2O$$
(2.8)

Ag/AgCl referansına karşı -0,9 V potansiyelden daha negatif potansiyellerde nitrat, hidroksil iyonları oluşturmak üzere indirgenir ve sonuç olarak elektrot yüzeyinin yakınında pH artar;

$$NO_3^- + H_2O + 2e^- \rightarrow NO_2 + 2OH^-$$
(2.9)

pH'daki bu bölgesel artış, denklem 3'te gösterildiği gibi bir titanyum hidroksit jelinin oluşması için gereklidir:

$$Ti(O_2)SO_4 + 2OH^- + (x+1)H_2O \rightarrow TiO(OH)_2.xH_2O + H_2O_2 + SO_4^{2-}$$
 (2.10)

Natarajan ve Nogami'nin diferansiyel termal analiz verilerine göre jel içindeki su 283°C civarında termal tavlama ile uzaklaştırılarak amorf bir TiO₂ fazı elde edilir. Sıcaklık 365°C'nin üzerine artırıldığında, anataz faz kristali oluşur:

$$TiO(OH)_2$$
. $xH_2O \rightarrow TiO_2 + (x+1)H_2O$ (2.11)

Karuppuchamy vd (2002) katodik elektrodepozisyonu 0,02 M TiOSO₄, 0,03 M H₂O₂ ve 0,1 M KNO₃ (pH=1,8) içeren sulu çözeltide ITO elektrot yüzeyinde -1,1 V'ta (vs. SCE) gerçekleştirerek elektrot yüzeyinde TiO(OH)₂xH₂O jel filmi oluşturmuşlardır. Sonrasında bu jel film, kristal halinde TiO₂ ince filmi elde etmek için 1 saat süreyle

400°C'de ısıl işleme tabi tutulmuştur. Elde edilen TiO₂ filmine ait XRD spektrumu Şekil 2.6'da verilmiştir.



Şekil 2.6. 0,02 M TiOSO₄, 0,03 M H_2O_2 ve 0,1 M KNO₃ çözeltisinde -1,1 V'ta katodik depozit edilmiş ve 400°C'de 1 saat ısıl işleme tabi tutulmuş TiO₂'in XRD spektrumu (Karuppuchamy *et al.* 2002)

Sankapal vd (2006) kimyasal ve elektrokimyasal yöntemler ile sentezlenmiş TiO₂ film yapılarını karşılaştırmışlardır. Her iki yöntem ile elde edilen TiO₂ yapılarının XRD ile karakterizasyonu yapılmıştır (Şekil 2.7). Elektrokimyasal sentez için oda sıcaklığında (25°C) muhafaza edilen 0,04 M TiOSO₄, 0,2 M H₂O₂ ve 0,1 M KNO₃ (pH~2) çözeltisi elektrolit olarak kullanılmıştır. Elektrokimyasal düzenek çalışma elektrodu ITO kaplı cam elektrot, referans doygun kalomel elektrot ve karşıt Pt elektrottan oluşan üç elektrotlu sistemdir. Depozisyon, 3 saat boyunca -1,2 V potansiyel uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Depozisyon sırasında, çözelti sürekli karıştırılmış, 3 saatlik deposizyon sunucunda 50 nm kalınlığa sahip pürüzsüz ve düz bir film elde edilmiştir. 3 saatten sonra çözeltideki hidroliz sonucunda beyaz amorf titanyum oksihidroksit jel partikülleri gözlemlenmiş ve elektrokimyasal hücrede oluşturulan jel tozu solüsyon filtrelenerek toplanmıştır. Filmler ve yan ürünler 400, 450 ve 500°C sıcaklıklarda havada ısıl işleme tabi tutulmuştur. 500°C'de 1 saat tavlama işleminin diğer sıcaklıklara

göre daha iyi kristalliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Tavlama işlemi, amorf filmin anataz fazına dönüştürülmesine izin vermiş ve uygun tavlama sıcaklığı 500°C seçilmiştir.



Şekil 2.7. X-ışını kırınımı desenleri a)ITO b)Kimyasal olarak oluşturulmuş TiO₂ c)Elektrokimyasal olarak depozit edilmiş 500°C 1 saat havada tavlanmış TiO₂ (Sankapal *et al.* 2006)

Elektrokimyasal depozisyon tekniğinde üretilen malzemelerin morfolojisinin uygulanan potansiyele büyük ölçüde bağlı olduğu iyi bilinmektedir. Lee ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, dendritik TiO₂ üretmek için 1,6 V'ta sürekli bir potansiyel (CP) ve -1,6/+1,6 V'da tekrarlanan bir alternatif puls (PRP) uygulanarak iki farklı metod kullanılmıştır. Şekil 2.8'de, gösterildiği gibi CP ve PRP ile sentezlenen TiO₂'in morfolojisi bir taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. TiO₂'nin katodik elektrodepozisyonunun bir yığın film yapısı oluşturduğu iyi bilinmektedir. CP modunda, büyük çatlaklara sahip tipik bir yığın film gözlenmiş (Şekil 2.8.a), PRP durumunda ise ortalama dal çapı yaklaşık 50 nm olan bir dendrit yapısı elde edilmiştir (Şekil 2.8.h).

Dendrit yapılarının büyüme mekanizması difüzyon sınırlı agregasyon (DLA) modeli kullanılarak açıklanmıştır. Başlangıçta TiO₂ öncülleri birbirleri ile bir araya gelir ve katodik (-1.6V) depozisyon sırasında ilk TiO₂ partikülleri oluşur. Pozitif potansiyel uygulandığında Ti(IV) hidroksil türleri pozitif uygulanan elektrik alandan dolayı çalışma elektrodunun yakınından uzaklaşır. Bu fenomen, elektrot yüzeyinde Ti(IV) hidroksil türünün düşük konsantrasyonuna sebep olur. Katodik depozisyonun ilerleyen aşamasında Ti(IV) hidroksil türleri TiO₂ yığınlarında adsorblanarak dentrit yapısını oluşturmak için dalların uçlarında ve saplarında büyüme meydana gelir. Ayrıca pozitif potansiyelde, NO3⁻ iyonları elektrot yüzeyine ulaşabilir ve negatif potansiyel uygulandığında Ti iyonu oluşturmak üzere Ti(IV) ile reaksiyona giren OH⁻ iyonlarına indirgenebilir. Sonuç olarak, elektrot/elektrolit arayüzünde Ti(IV) konsantrasyonu, nitrat iyonlarının katodik indirgenmesiyle azalır. Ti(IV)'ün elektrot yüzeyine yaklaşması için daha önceden ortamda bulunan Ti(IV) difüzyonu kolaylaştırır. Elde dendrit yapısını kuvvetle etkileyen edilen elektrot yüzeyindeki Ti(IV)'ün konsantrasyonu pozitif potansiyelin şiddetinden etkilenir (Şekil 2.8. c-h). Daha yüksek bir pozitif potansiyel uygulayarak hazırlanan TiO2'nin daha sert bir dendrit yapısına sahip olduğu açıkça görülmektedir (Lee et al. 2015).



Şekil 2.8. CP tekniği (A ve B) ve PRP tekniği (C-H) ile sentezlenen TiO₂'in SEM görüntüleri

 \overline{C} ve D -1,6/0 V; e ve f -1,6/1,0 V; g ve h -1,6/1,6 V puls uygulamalarına aittir. A, C, E, G düşük büyütme ve B, D, F, H yüksek büyütme görüntüsüdür (Lee *et al.* 2015)

2.2. GO'in Elektrokimyasal İndirgenmesi

Elektrokimyasal prosedür tek ve iki aşamalı olmak üzere farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir. Elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit (ERGO) ince filmleri üretmek için tek kademeli elektrokimyasal sentez yönteminde, tampon ortamında sulu bir koloidal süspansiyondan GO tabakaları elektrot yüzeyinde doğrudan elektrokimyasal olarak indirgenebilir. Elektrokimyasal indirgeme işlemi, oda sıcaklığında standart üç elektrotlu bir elektrokimyasal sistemde dönüşümlü voltametri (CV), doğrusal tarama voltametrisi (LSV), diferansiyel puls voltametri (DPV) ve sabit potansiyel (CP) teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir (Çizelge 2.1).

NO	Elektrokimyasal	Referans	Karşıt	Çalışma	GO'in	Destek	Elektrolit	Uygulanan	Elektrokimyas	C/0
	Teknikler	Elektrotlar	Elektrotlar	Elektrotlar	birikme	elektrolitler	ortammm pH	potansiyeller	al zamanları	Oranları
_					medotu		değeri			
1		0.07	D (1)	0000	D	PBS (KH ₂ PO ₄ /		-0.80V, -0.10V,		3.57, 3.85,
	Sabit potansiyel	SCE	Pt tel	GC/GO	Damlatma	K ₂ HPO ₄)	5.1-2,2	-0.12V, -0.14V,	3 dakika	4.35, 5.00,
_								-0.16V		5.56
2	0-14		D. 11.1		D	0.5 M	27/4			27/4
	Sabit potansiyel	Ag/AgCl	Pt disk	Au/Pt/GO	Damlatma	NaNO ₃	N/A	-1.1V	4.5 saat	N/A
						0.051/0000				
3					-	0.05 M PBS		-1.2V & -1.7V		
	Sabit potansiyel	SCE	Pt tel	GC/GO	Damlatma	(KH2PO4/	0.0		600 saniye	N/A
						K ₂ HPO ₄)				
4		A 14 CT	P (C)	00/00	D 1/	0.1.1.1.170	27/4		6.1.1.7	37/4
	Sabit potansiyel	Ag/AgCI	Pt tolyo	GC/GO	Damiatma	0.1 M KCI	N/A	-1.1V) dakika	N/A
_						()()))				
5					D	1 M PBS				
	Sabit potansiyel	Ag/AgCl	Pt tel	GC/GO	Püskürtme	(NaH ₂ PO ₄ /	4.12	-0.90V	5000 saniye	24.3
_	T					Na ₂ HPO ₄)				
0	Donuşumlu		Dec 1	COMPANIE AN		0.2 M PBS	7.0	0V ile -1.4V	45	27/4
	voltametri	Ag/AgCl	Pt tel	GC/HDA/	Daldırma	(NaH ₂ PO ₄ /	/.0	(50mV s ⁻¹)	15 çevrim	N/A
_	D			GO		Na ₂ HPO ₄)		AV 1. 1 5V		
1	Donuşumlu	0.07	Dec 1	00100	D	0.05 M PBS	5.0	0V fle -1.5V	100	27/4
	voltametri	SCE	Pt tel	GC/GO	Damiatma	(NaH2PO4/	2.0	(100 mV s ⁻⁺)	100 çevrim	N/A
	D	COL	Di Cilia	Automati	Tababa (dada	Na ₂ HPO ₄)		0173-1017	2	N1/4
ð	Donuşumlu	SCE	Pt tolyo	AuCyst	Tapaka-tapaka	0.1 M KNO3	27/4	0 V 11e -1.0V	2 çevrim	N/A
0	Voltametri			GU	Demleters	0.114	N/A	(10 mV s ⁻¹)	1500	N/A
y	Donuşumlu	DITE	Di Gilina	00/00	Damiauna	N- 80	IN/A	-1.0V file 1.0V	1500 çevrim	N/A
10	voitametri	KHE	Pt tolyo	GC/GO		Na2504		(50 m V s ·)		
10	Donuşumlu	0.05	D .	00/00	D 1/	0.01 M PBS	5.0	UV 11e -1.5V	27/4	27/4
	voitametri	SCE	rt	GC/GO	Damiatma	(KH2PO4/	5.0	(50 mV s ⁻¹)	IN/A	N/A
11	D#########				Daldama	K2HPO4)	20	0.117.3- 1.117	2	N/A
11	Donuşumlu	A = / A = C1	Detail	4	Daldima	0.1 M KNO3	2.0	0.1V file -1.1V	∠ çevrim	N/A
12	Voitametri	Ag/AgCI	Pt tei	AUGU	Daldama	0.5 M N-Cl	NI/A	0703-110	2	NI/A
12	Donuşumlu	A - (A - C1	De	GU/APTES/	Daidima	0.5 M NaCI	IN/A	0./V 110 -1.1V	5 çevrim	IN/A
	voltametri	Ag/AgCl	Pt	60				(COM V S**)		

Cizelge 2.1. Elektrokimyasal indirgeme işlemleri (Toh *et al.* 2014)

Grafen oksitin (GO) indirgenmesi ile elde edilen grafen malzemeleri düşük maliyetle çok miktarda üretilebilir ve satılabilir. Grafen oksitin indirgenmesi ile C/O oranı artar

(iki katına çıkar) (Glover *et al.* 2011). Bu artış grafen oksitin bandgap aralığının küçülmesine neden olarak numunenin iletkenliğinin artmasına neden olur ve böylece numune iletkenlik kazanır. Eksfolitasyon edilmiş GO; kimyasal, termal, elektrokimyasal ve mikrodalga yardımlı tekniklerle indirgenebilir. GO'in kimyasal indirgnemesinde kullanılan hidrazin, alkalin, etilendiamin, NaBH₄ ve üre gibi indirgeyici reaktiflerin çoğunun zehirli, aşındırıcı veya patlayıcı olması ciddi güvenlik ve çevre sorunları oluşturmaktadır. Ayrıca, daha iyi dağılmış indirgenmiş GO elde etmek için bu proseslerde kullanılan reaktifler elektronik özelliklerde bozulmalara sebep oldukları için istenmeyebilir. Bu nedenle, fazla üretme imkânı sağlayan ve daha çevresel olan elektrokimyasal yöntem tercih edilmektedir. GO'in elektrokimyasal olarak indirgenmesi; 1,5-12,5 gibi geniş bir pH aralığında, belirli bir zaman periyodunda ve sabit negatif potansiyel altında (-1,2 V) gerçekleştirilebilir (Guo *et al.* 2009).

Araştırma grubumuz tarafından daha önce gerçekleştirilen çalışmada GO'in elektrokimyasal indirgenmesi için iki farklı prosedür kullanılmıştır. GO süspansiyonu 0,1 M KNO₃ ve pH 2 tamponundan oluşan elektrolit ortamında hazırlanmış ve Au elektrot yüzeyinde doğrudan veya adsorplanan GO türlerinin indirgenmesi sağlanmıştır. Au elektrot ile yapılan voltametrik incelemelerde GO'in doğrudan indirgenmesinde -0,4 ile -0,6V potansiyel aralığında düşük şiddetli ve -0,6 ile -0,8V potansiyel bölgesinde geniş iki pik gözlenmiştir. Adsorplanmış GO'in elektrokimyasal indirgenmesinde ise farklı olarak tek pik oluşumu tespit edilmiştir. Au(111) elektrot yüzeyinde elektrokimyasal olarak indirgenen GO nanoyapılarının atomik yapısı ve boyutları STM tekniği ile karakterize edilmiştir (Şekil 2.9). Şekil 2.9.a'da gösterildiği gibi 1 nm'lik tabaka kalınlığında ERGO yapıları görülmüştür. Bu tabaka kalınlığı yaklaşık olarak tek bir tabakaya karşılık gelmektedir. ERGO yapılarının atomik boyutlu STM görüntüsünde ise yapısal kusurlar ilk kez net şekilde gözlenebilmiştir (Şekil 2.9.b). Bu STM görüntüsünde oksijen içeren fonksiyonel grupların elektrokimyasal indirgenme ile yapıyı terk etmesiyle oluşan boşluk bölgeleri A, ve ERGO yapılarının atomik boyutta elektrot yüzeyine adsorblanması ile oluşan ad-atom kusurları B gösterilmiştir. Yapılan bu çalışma ile ek modifikasyon işlemi olmaksızın elektrot yüzeyinde doğrudan ERGO yapılarının oluşumu sağlanmıştır.



Şekil 2.9. a) Au(111) substrat yüzeyine depozit edilen ERGO filminin geniş ölçekli STM görüntüsü b) Boşluk kusurları (A) ve adsorplanmış atomları (adatom) (B) gösteren atomik boyutlu STM görüntüsü (Öztürk Doğan *et al.* 2013)

Yang ve Gunasekaran (2013) tekrar eden katodik çevrimsel potansiyel döngüsü ile GO'ten elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit (ERGO) yapılarını sentezlemişlerdir. Yüksek negatif potansiyel uygulandığında (-1,5 V), oksijen içeren fonksiyonel grupların yapıdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Elektrokimyasal indirgenme sonrası GO'te meydana gelen değişim UV-vis spektroskopi ile izlenmiştir (Şekil 2.10.a).



Şekil 2.10. (A) ERGO'nun SEM görüntüsü. (B) 20 μg mL⁻¹ için UV–vis spektroskopisi (a) GO (b) ERGO. Sağ üstteki fotoğraflar GO ve ERGO dispers çözeltilerini göstermektedir. Sol alt ERGO dispers çözeltisinin büyütülmüş görüntüsüdür. (C) Farklı pH'lar altında GO'in ve ERGO'in Zeta Potansiyeli. (Yang and Gunasekaran 2013)

Elektrokimyasal indirgenme öncesi GO'e ait 230 nm'deki absorbsiyon piki, aromatik C-C bağlarının $\pi \rightarrow \pi^*$ geçişlerine karşılık gelmektedir. Elektrokimyasal indirgemeden sonra, absorbsiyon pikinin 270 nm'ye kırmızıya kaydığı gözlemlenmiştir (pik şiddetindeki azalma ok işareti ile gösterilmiştir). Bu kırmızıya kayma ERGO tabakaları içinde π konjügasyonunu desteklemektedir. Şekil 2.10.a'daki UV spektrumları, hidrazin indirgenmesinde alınan spektrumları yakındır. Sulu çözeltide iyi bir şekilde dağılmış GO, kahverengi renkte olup aylarca sürebilen iyi dağılım ve kararlılık gösterir. Bunun sebebi GO'in kenar ve yüzeyinde bulunan oksijen gruplarıdır. Buna karşılık, ERGO çözeltide siyah bir renk gösterir ve çözünmeyen küçük parçacıklar gözlemlenebilir. Hidrofobiklikteki artış indirgemeden sonra elektrokimyasal olarak kararsız oksijen içeren fonksiyonel grupların başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır. Yüzey özelliklerini daha fazla keşfetmek için, zeta potansiyelleri pH'nın bir fonksiyonu olarak ölçülmüştür (Şekil 2.10.b). 5 ila 8 pH aralığında GO tabakalarının zeta potansiyel değerleri -29,0 mV'dan -37,3 mV'a düşmüştür. Bu düşüş GO yüzeyine bağlanmış oksijen türlerinin negatif yüklemesi ile ilişkilendirilmektedir. Karboksilat grupları içindeki karboksil gruplarının pH 8'de deprotonasyonu, zeta potansiyelindeki negatif yük artışına sebep olmaktadır. Genel kolloidal bilimine göre, 30 mV'tan büyük mutlak değerlerdeki zeta potansiyelleri kararlı bir dağılıma neden olabilir. Bu yüzden GO dağılımı, Şekil 2.10.a'da görüldüğü gibi elektrostatik itme nedeniyle iyi korunabilir. Öte yandan ERGO, sıfırın civarında zeta potansiyel değerleri göstermiştir. pH<7'de ERGO'in pozitif zeta potansiyel değerleri, negatif yüklü oksijenleşmiş türlerin kaldırılması sonucu sulu çözeltideki pozitif yüklü iyonların (H⁺, Na⁺ gibi) adsorbsiyonuyla ilişkilendirilmektedir. Bu ayrıca termal ve kimyasal olarak indirgenmiş GO için de gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar GO'in verimli bir şekilde elektrokimyasal olarak indirgenebileceğinin göstergesidir (Yang and Gunasekaran 2013)

İletken yüzeyler üzerine oluşturulan GO bazı organik çözücülerde de elektrokimyasal olarak indirgenebilir. GO'in neredeyse tamamen indirgenmesi için gereken elektrik miktarı 1 mg GO için 2.0 C'tur. Bu grafendeki her bir benzen halkasının indirgenebilir türüne bir elektron bağlanmasına karşılık gelir. ERGO filmi, yaklaşık 3 S.cm⁻¹'lik bir elektriksel iletkenlik kazanmıştır ve propilen karbonat içinde 147,2 F.g⁻¹ nispeten yüksek kapasitans sergilemiştir (Harima *et al.*2011).

Harima vd (2011) GO'in elektrokimyasal indirgenmesi için su yerine organik çözücü kullanılan yeni ortamlar belirlemişlerdir. İletken substratlar üzerinde GO filmlerinin akım-voltaj eğrileri, GO'in asetonitril (AN), dimetilformamid (DMF), dimetilsülfoksid (DMSO) ve propilen karbonat (PC) içerisinde başarıyla indirgenebildiğini göstermiştir. PC'de indirgenmiş GO filmleri diğer çözücülerde elde edilenlere kıyasla daha yüksek spesifik kapasitans verimine sahiptir. GO'in elektrokimyasal indirgenmesinin Al elektrotlarda uygulanabilir olduğu bulunmuştur ve bu elektrotta elde edilen spesifik kapasitans, diğer metal elektrotların değerlerine yakındır.

Kauppila vd (2013) GO filmlerinin elektrokimyasal indirgemesi için, şeffaf SnO₂ çalışma elektrodu kullanılarak çeşitli çözeltiler içerisinde dönüşümlü voltametri tekniğini kullanmışlardır.. Sadece birkaç nanometre kalınlıkta GO filmleri elde etmek için, şeffaf SnO₂ üzerine spin tekniğiyle damlatılmıştır. Farklı tarama hızları GO indirgemesi için test edilmiş ve CV ölçümleri için 10 mV/sn tarama hızı şeçilmiştir (Şekil 2.11).



Şekil 2.11. pH 2'de (a) ve pH 12'de (b) 0.1 M fosfat tamponu içerisinde 10 mV/s tarama hızında GO film indirgemesinin dönüşümlü voltomogramı Noktalı çizgi aynı koşullar altında yalın SnO₂ elektrotunun dönüşümlü voltamogramını göstermektedir. Ok yönü potansiyel taramanın yönünü belirtir (Kauppila *et al.* 2013).

Sulu çözeltilerdeki GO için alınan dönüsümlü voltamogramlarda (Sekil 2.11), 10 mV/s tarama hızında pH 2'de 0 ile -0,8V arasında ve pH 12'de 0'dan -1,3V'a çevrim ile GO'in indirgenmesi sağlanmıştır. Şekil 2.11.a ve Şekil 2.11.b'deki birinci potansiyel çevrimlerini karşılaştırdığımız zaman, ilk çevrimlerde indirgenme akımının en büyük değere sahip olduğu görülmektedir. Üçüncü çevrimden sonra ise küçük değişiklikler meydana gelmektedir. Bu GO filminin indirgeme reaksiyonunun çok hızlı olduğunu açıklamaktadır. pH 12'de GO filminin indirgenme piki -1,0 V civarında (Ag/AgCl'e karşı) görülmektedir; fakat pH 2'de sadece -0,7 V'da bir omuz görülür. Bu pH farklılığına bağlı sonuçlar literatür raporlarıyla uyumludur. Çünkü düşük pH değerlerinde protonların indirgenmeyi hızlandırdığı literatürde açıklanmıştır. pH 2'de yalın SnO₂ (noktalı çizgi) ve SnO₂-GO (düz çizgili) elektrotlar için alınan voltamogramlarda (Şekil 2.11.a) ters yönde tarama yapıldığında yaklaşık -0,58 V civarında belirgin bir oksidasyon piki görülmektedir. Bunun sebebi, redüksiyon sırasında oluşan metalik Sn'ın yeniden oksitlenmesidir. SnO2'in redoks reaksiyonlarının asidik ortamda oldukça düşük potansiyellerde meydana geldiği bilinmektedir. Yüksek pH'da SnO₂ daha kararlı olduğu için pH 12'de ölçülen voltomogramlarda benzer oksidasyon piki gözlemlenmemiştir.

Basirun vd (2013) GO filmini grafit elektrot üzerine buharlaştırmış ve voltametrik çevrim aracılığıyla 6 M KOH çözeltisinde elektrokimyasal olarak indirgemişlerdir. ERGO filminin oluşumu 25 mV/s tarama hızında 40 çevrim olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Voltametrik incelemede çözeltiden oksijen uzaklaştırılmasının etkisi araştırılmıştır. Oksijen içeren çözeltide sistemden geçen hem akım hem de yük, pozitif ve negatif taramaların her ikisi için de daha yüksek bulunmuştur. Bu durum GO'in elektrokimyasal indirgenmesinin yanı sıra oksijen indirgenme reaksiyonun da gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Tong vd (2013) iki elektrotlu bir sistem kullanarak GO'ten ERGO sentezini gerçekleştirmişlerdir. Şekil 2.12'de gösterilen elektrokimyasal hücrede, katodik çalışma elektrodu gibi davranan 10-14 tane grafit elektrotlar (her biri yaklaşık 0.3 cm çapında) yüzeyinde ERGO elde edilmiştir. Anodik elektrot olarak platin plaka kullanılmıştır. Toz

olarak sentezlenen 1g GO hücre içerisinde dağıldıktan sonra çözelti karıştırılarak elektrokimyasal indirgenmiştir. Elektrolit çözeltisi 0,1M KNO₃'tır. Güç kaynağından 20V uygulanmış ve indirgeme süresi 10 dakika ile 24 saat arasında değiştirilmiştir.



Şekil 2.12. GO'in elektrokimyasal indirgenmesinde kullanılan hücre şekli (Tong *et al.* 2013).

GO'in elektrokimyasal indirgenmesi renk değişimine sebep olur. Tong ve arkadaşları (2013) GO'te meydana gelen bu renk değişimini indirgenme süresine bağlı olarak takip etmişlerdir. Şekil 2.13'te gösterildiği gibi, sarı-kahverengi GO süspansiyonu 10 dakika elektrokimyasal indirgeme sonrasında hızla kahverengi-siyaha dönüşmektedir. Süspansiyon 1 saat sonra homojen siyah rengi almıştır. Bir gece boyunca bekletildiğinde siyah tortunun beherin tabanında çöktüğü gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar GO'in elektrokimyasal indirgeme ile hızlı oksijensizleştirildiğini ortaya koymaktadır.



Şekil 2.13. 0,1 M KNO₃ çözeltisinde indirgememiş GO ve 20 dakika, 30 dakika ve 1 saatlik elektrokimyasal olarak indirgenmiş GO süspansiyonunun eksfoliyasyon görüntüleri (Tong *et al.* 2013)

Bikkarolla vd (2014) yaptıkları çalışmada ERGO, N₂ doyrulmuş 0,1 M Na₂SO₄ çözeltisi içinde 0 ile +1,5V potansiyel aralığında tekrarlayan katodik çevrim ile grafen oksidi indirgeyerek sentezlenmiştir. GO'e kıyasla elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen oksit'in (ERGO) gelişmiş elektron transfer yeteneği olduğu elektrokimyasal impedans spektroskopisi ile belirlenmiştir (Bikkarolla *et al.* 2014).

TiO₂-GO kompozitleri sentezlemek için literatürde hidrotermal, fototermal ve anodik oksidasyon teknikleri ile yapılan çalışmalar mevcuttur. Te ve TiO₂ gibi fotokatalitik özelliği olan bir yarıiletken kullanılarak GO'in fotokatalitik indirgenmesi araştırılmıştır. Te nanoteller ile oda sıcaklığındaki GO karışımındaki reaksiyon incelendiği zaman; Te nanotellerin TeO₃^{2-,} oksitlenirken GO'in grafen yapısına indirgendiği belirlenmiştir. Reaksiyonun pH'ya oldukça güçlü bir şekilde bağlı olduğu ve sadece bazik pH'larda reaksiyonun olabilirliğinin mümkün olduğu bulunmuştur. Asidik ortamda GO agregatları indirgenmeyi zor kılarlar, daha yüksek sıcaklıkta reaksiyon hızlı iken daha düşük sıcaklıkta reaksiyonun daha yavaş geliştiği düşünülebilir (Sreeprasad *et al.* 2009). Bir başka çalışmada TiO₂ süspansiyonunda grafen oksitin UV-yardımlı indirgenmesini

gerçekleştirmişlerdir. Bunun için etanolde kolloidal TiO₂ ve grafen oksit karışımı hazırlanmış ve sabit dalga boylu UV-ışınına tabi tutulmuştur. 15 dakikalık sürelerde UV-absorpsiyon spektrumundaki değişiklik incelenmiştir. Örnekler çözeltiden azot geçtiği sırada beyaz ışık altından 0,5 cm optiksel olarak geçirgen hücrede hazırlanmıştır. Parlak kahverengi, koyu kahverengiden siyaha kadar renklerdeki değişim GO'in indirgenmesinde görülebilmektedir. Bu renk değişimi karbon yapısındaki π bağının kısmi değişmesi olarak önerilmekte ve GO tabakalarının kimyasal indirgenmesine tanık olmaktadır. Süspansiyona TiO2 eklendiği zaman UV-ışınında gözlenen absorpsiyonda dikkati çeker bir değişiklik olmamıştır. Bu GO'in indirgenmesinde TiO₂'in ara rol oynadığını göstermektedir. Süspansiyonlarda yüzey yükü TiO₂ parçacıklarla taşındığı için, polar çözücülerde askıda kalarak hazırlanabilir. Bu nedenle, TiO₂-grafen kompozit malzemesi polar çözücülerde çözünür. UV-ışınına maruz kaldıktan sonra da süspansiyon yaklaşık bir saat süreyle dengededir. Etanol ortamında elektronlar ilk olarak TiO₂ tarafından tutulur. TiO₂'de biriktirilmiş elektronlar fonksiyonel grupları indirgemek için grafen oksit tabakalarıyla etkileşirler. Bu etkileşim aşağıdaki denklemle ifade edilmiştir:

$$\operatorname{TiO}_2 + hv \to \operatorname{TiO}_2(h+e) + \operatorname{C}_2\operatorname{H}_5\operatorname{OH} \to \operatorname{TiO}_2(e) + \operatorname{C}_2\operatorname{H}_4\operatorname{OH} + \operatorname{H}^+ \qquad (2.12)$$

$$TiO_2(e)$$
 + grafen oksit (GO) \rightarrow TiO_2 + indirgenmiş grafen (GR) (2.13)

Bu yöntemde indirgenme reaksiyonunun başlatılması için UV-ışını gönderilmelidir (Şekil 2.14). Ancak yöntemin ilerleyen basamaklarında çözücünün buharlaştırılması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak elde edilmesi planlanan TiO₂-grafen yapısı toz halinde olmaktadır ve tekrar bir çözücü ortamına aktarılması gerekmektedir (Williams *et al.* 2008).



Şekil 2.14. TiO₂ kullanılarak GO'in fotokatalitik indirgenmesi (Torres *et al.* 2012)

Alternatif bir yöntem olarak TiO₂-indirgenmiş grafen oksit nanokompozitlerinin sentezi indirgeyici ajan olmaksızın tek-aşamalı hidrotermal reaksiyon ile Shah vd (2012) tarafından gerçekleştirilmiş ve kompozitin sentezi Şekil 2.15'te şematik olarak verilmiştir. Bu çalışmada Ti kaynağı olarak TiCl₄ kullanılmış ve hidrotermal şartlar altında TiCl₄'ün hidrolizi ile GO'in indirgenmesi eş zamanlı olarak yapılmıştır.



Şekil 2.15. TiO₂-İndirgenmiş grafen oksit nanokompozit sentez şeması (Shah *et al.* 2012)

Chen ve arkadasları (2016) Ti folyo üzerine anodik oksidasyon yöntemi kullanılarak oda sıcaklığında iki elektrotlu hücre sisteminde kütlece %0,5'lik amonyumflorit (NH₄F), hacimce %97'lik etilen glikol ve %3 sudan oluşan elektrolit içerisinde, karıştırılarak 50 V sabit potansiyel 30 dakika süre ile uygulandığında TiO₂ nanotüplerini biriktirmişlerdir. Elektrot hazırlama işlemi Şekil 2.16'da şematik olarak gösterilmiştir. Hazırlanan TiO₂ nanotüpleri 400°C'de azot atmosferinde 4 h tavlanarak anataz kristal formuna dönüştürülmüştür. Toz halindeki GO pH'sı 9,32 olan 0,1 M Na₂HPO₄-NaH₂PO₄ fosfat tamponu içerisine konsantrasyonu 0,5 mg.mL⁻¹ olacak şekilde ilave edilmiş ve 90 dakika ultrasonik banyoda sonike edilmiştir. Sonrasında GO içeren çözelti Ti/TiO₂ çalışma elektrodu, Pt karşıt elektrot ve SCE referans elektrodundan oluşan üç elektrotlu hücrede dönüşümlü voltametri tekniği ile indirgenmiştir. -1,5 V ile 1,0 V potansiyel aralığında 30, 40 ve 50 mV/s tarama hızlarında tarama yapılarak ERGO yapısına dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Voltametrik çevrim sayıları değiştirilerek Ti/TiO₂ elektrot yüzeyinde grafen yapısının depozisyonu kontrol edilmiştir. GO'in farklı çevrim sayılarında indirgenmesi için alınan SEM görüntüleri Şekil 2.17'de gösterilmiştir.



Şekil 2.16. TiO₂ nanotüp (TNT) üzerine elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen oksit (ERGO)'in hazırlanış şeması (Chen *et al.* 2016)



Şekil 2.17. (a) 16 çevrim, (b) 26 çevrim ve (c) 36 çevrim ile TNT üzerine elektrodepozit edilmiş ERGO elektrotların FESEM görüntüleri (d) 30, 40 ve 50 mV/s'de 36 çevrim için ERGO'in Raman spektrumu. (Chen *et al.* 2016)

TiO₂ ve grafen oksit (GO) filminin elektrokimyasal depozisyonu için Oliveira ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada 30 cm²'lik geometrik alana sahip 2 mm kalınlığında saf Ti levhası çalışma elektrodu kullanılmıştır. TiO₂/GO filmini elde etmek için elektrokimyasal deneyler, bir destek elektroliti olarak pH 9,0'da fosfat tamponunun 150 mL'sinde 15 mg GO ve 100 mg K₂TiF₆ karışımını kullanarak gerçekleştirilmiştir. Bu çözelti ortamında alınan voltamogram Şekil 2.18'de verilmiştir. Elektrodepozisyon işlemi 50 mV/s'lik tarama hızında 0 ile 5,0 V potansiyel aralığında gerçekleştirilmiştir. Alınan voltamogramda 1,9 V ve 2,9 V bölgelerinde iki anodik pik tespit edilmiştir. 2,9 V yakınındaki zayıf şiddetli pik artan çevrimlerde kaybolmuştur. Artan çevrimlerde 1,9 V potansiyel değerinde gözlenen pikin şiddetinde ise azalma görülmüştür. Bu azalmanın sebebi; elektrolitte bulunan K₂TiF₆ içerisindeki Ti(IV) iyonlarının hidroliz olmasından kaynaklı birkaç oksit tabakasının oluşması olarak düşünülmüştür.



Şekil 2.18. Ti/TiO₂/GO elektrot için; 8, 10 ve 25 çevrim'de anodik eğrileri ve pozitif tarama sırasında gözlenen anodik CV piki (Oliveria *et al.* 2016).

3. MATERYAL ve YÖNTEM

3.1. Materyal

3.1.1. Elektrokimyasal hücreler

Elektrokimyasal reaksiyonlarda reaksiyonu başlatacak dışarıdan bir elektrik akımı sisteme verilir ve böylelikle maddelerde yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlarının gerçekleşmesi sağlanır. Elektrokimyasal reaksiyonlar elekrokimyasal hücrelerde gerçekleştirilir. Bir elektrokimyasal hücre;

- indirgenebilecek veya yükseltgenebilecek elektroaktif bir türü,
- bu türün içerisinde çözüneceği uygun bir çözücüyü,
- iletkenlik sağlaması ve iyonların hareketi için destekleyici elektroliti,
- üzerinde elektron alış-verişinin gerçekleştiği elektrotları ve
- bu elektrotların voltaj/akım değerlerini uygulayacak potansiyostat bağlantısını içerir.

Elektrokimyasal hücreler galvanik ve elektrolitik olmak üzere iki çeşide ayrılır. Elektrik enerjisi üreten hücreler galvanik hücre olup, elektriği dışarıdan alıp harcıyorsa elektrolitik hücre olarak adlandırılır. Elektrokimyasal sentezlerde iki tür hücre de kullanılır. Hücrelerin çoğu, deney koşulları değiştirilerek galvanik veya elektrolitik amaçlarla çalıştırılabilir. Hücreler elektrot sistemlerine göre iki veya üç elektrotlu hücreler olmak üzere iki sınıftır (Şekil 3.1). İki elektrotlu sistemler, çalışma elektrodu ve karşıt elektrottan meydana gelir. İki elektrot arasına uygulanan potansiyel, elektrotlu sistemler ancak düşük dirençli çözelti ortamlarında çalışır. Yüksek dirençli ortamında ohmik düşme (IR) artacağından, bu sistemlerin işlevi IR düşmesinin büyüklüğü ile sınırlıdır. IR potansiyel düşmesinden kaynaklı sorunlardan, elektroaktif maddelerin indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerinin tam olarak belirlenememesi ve çalışma

elektrodunun potansiyelinin zamanla değişmesi gibi dezavtajlardan kurtulmak için üç elektrotlu hücre kullanımı daha çok tercih edilmektedir.

Elektroliz yapılacak çözeltinin tamamını elektrokimyasal hücre sisteminde durgunsa "grup tip", elektroliz çözeltisi hücre sistemine gönderilip hücre sisteminden çıkışında elektroliz edilmiş çözelti alınıyorsa "akıcı tip" olarak adlandırılır. Grup tip hücreler küçük miktarlarda elektroliz için kullanılırken akıcı tip hücreler büyük miktarlarda elektroliz için kullanılır. (Goodridge and King 1974). Ayrıca hücre sistemleri bölünmüş ve bölünmemiş hücre olarak ikiye ayrılmaktadır. Bölünmemiş hücre sisteminde çalışma, karşıt ve referans elektrot hücre içerisinde tek bölmeye yerleştirilir. Bölünmüş hücre sistemlerinde ise üç elektrot farklı bölmelere yerleştirilir. Reaksiyon türüne göre hücre sistemi basit veya karmaşık olabilir. Ayrıca hücre sisteminin atmosferde bulunan indirgeyici etkiye sahip oksijenden korunması için, kapalı tip hücreler ve inert argon gaz geçişi kullanılmaktadır.



Şekil 3.1. İki (a) ve üç (b) elektrotlu elektrokimyasal hücre sistemleri

Üç elektrotlu hücrelerde; karşıt, çalışma ve referans elektrotu olarak adlandırılan elektrotlar, içinde elektroaktif bir bileşik ile elektrolitin çözündüğü çözücüye daldırılmıştır. Deneylerde indiyum kalay oksit (ITO) kaplı kuvartz cam çalışma elektrodu, platin tel karşıt elektrot ve Ag/AgCl referans elektrot olarak kullanıldı. Elektrokimyasal çalışmalar sırasında inert azot (N2) gazı sistemden geçirilmek suretiyle depozisyon yapılmıştır.



Şekil 3.2. Çalışmamızda kullanılan elektrokimyasal hücre sistemi gösterimi

3.1.1.a. Referans elektrot

Referans elektrotlar; kendisi reaksiyona girmeyen ve çalışma elektrodunda gerçekleşen indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerinin doğru olarak belirlenebilmesi için potansiyostat cihazı tarafından potansiyeli referans olarak alınan elektrotlardır. Bir elektrokimyasal hücrede çalışma elektrodunda gerçekleşen indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerinin doğru olarak belirlenebilmesi, bağlantılardaki ve çözelti içindeki potansiyel kaybının önlenebilmesi ve ayrıca çözelti direncinin giderilmesi için referans elektrot kullanılmalıdır.

Bir referans elektrot aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

- sabit ve değeri bilinen potansiyeli olmalı,
- polarize olmamalı,
- çalışılan çözeltinin bileşenlerinden etkilenmemeli,
- kolay hazırlanabilmeli,
- belli bir akım aralığında tersinir davranmalı,
- gerilimin sıcaklıkla değişme katsayısı küçük olmalıdır.

Standart hidrojen referans elektrot (SHE), yarı-hücre potansiyelleri hakkında bilgi veren referans elektrotudur. SHE'lar pH ölçümlerinde indikatör elektrot olarak kullanılabilirler. SHE'un potansiyeli çözeltideki hidrojen iyon konsantrasyonuna, sıcaklığa ve elektrot yüzeyindeki hidrojenin basıncına bağlıdır. Yarı hücre sisteminin referans elektrot konumunda çalışabilmesi için bu parametrelerin dikkatli seçilmesi gerekir. SHE'un potansiyeli tüm sıcaklıklarda sıfır volt kabul edilmektedir.



 $2H^+(aq) + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$

Şekil 3.3. Standart hidrojen referans elektrot (SHE)

Doygun kalomel referans elektrot (SCE) kolay hazırlanabilir olduğu için çok kullanılan bir elektrottur (Şekil 3.4). SCE, Hg₂Cl₂ ve metalik civadan meydana gelen bir karışım ve doygun KCl çözeltisinden oluşur. Standart hidrojen elektrot'a karşı SCE'un potansiyeli, 25°C'de 0,244 V'tur. SCE'da meydana gelen dönüşümlü reaksiyon:

$$Hg_2Cl_{2(k)} + 2e^{-} \leftrightarrow 2Hg_{(k)} + 2Cl^{-}$$
(3.1)



Şekil 3.4. Doygun kalomel referans elektrot (SCE)

Laboratuarda oldukça sık kullanılan referans elektrotlar doygun kalomel referans elektrodu (SCE) ve Ag/AgCl referans elektrodudur. Her iki referans elektrot da bir metal ve o metalin az çözünen tuzundan yapılır. SCE elektrotların 60°C'ın üzerindeki sıcaklıklarda kullanımı kısıtlı iken Ag/AgCl referans elektrotlar ile daha yüksek sıcaklıklarda çalışılabilmektedir. Bunun yanı sıra civa insan sağlığına zararlı son derece zehirli bir metaldir ve civa(I) iyonları, gümüş iyonlarına göre daha fazla numune bileşeniyle reaksiyona girer ve bu tür reaksiyonlar elektrotla analit çözeltisi arasındaki bağlantının tıkanmasına neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı Ag/AgCl referans elektrotları kullanımak daha avantajlıdır. Ag/AgCl referans elektrodu Şekil 3.5'de gösterilmiştir.



Şekil 3.5. Ag/AgCl referans elektrodu

Bir Ag/AgCl referans elektrot, gümüş tel elektrolitik yoldan AgCl ince tabakası ile kaplanması ve bu telin AgCl-KCl yönünden doygun bir çözeltiye daldırılmasıyla elde edilir. Ag/AgCl elektroduna ait yarı hücre tepkimesi,

$$\operatorname{AgCl}(k) + e^{-} \rightarrow \operatorname{Ag}(k) + \operatorname{Cl}^{-}$$
 (3.2)

şeklindedir ve elektrot potansiyeli,

$$E = E^{0}_{Ag/AgCl} - 0.059 \log_{Cl}$$
(3.3)

eşitliği ile verilir. Ag/AgCl elektrodun potansiyeli, standart hidrojen elektrot referansına karşı karşı 25°C'de 0,199 V olarak ölçülmüştür.

3.1.1.b. Karşıt elektrotlar

Bir elektrokimyasal hücrede karşıt elektrot devreyi tamamlayıcı olarak görev alır. Elektrokimyasal reaksiyonlarda karşıt elektrot olarak genelde Au, Pt, C gibi saf metaller ve çeşitli metal oksitler kullanılmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında ise karşıt elektrot olarak platin tel elektrotlar (Şekil 3.6) kullanıldı.



Şekil 3.6. Pt tel karşıt elektrotlar.

3.1.1.c. Çalışma elektrodu

İncelenmek istenen elektroaktif türün elektrokimyasal reaksiyonun meydana geldiği elektrot çalışma elektrotudur. İdeal bir çalışma elektrotunun, analit iyon aktivitesindeki değişimlere hızlı ve tekrarlanabilir cevaplar vermesi istenir. Çalışma elektrotu seçilirken aktivitesi ve yüzey morfolojisi göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrokimya uygulamalarında, çalışma elektrodu Au, Pt, C gibi "inert" bir materyaldir. Şekil 3.7'te camsı karbon çalışma elektrodu verilmiştir.



Şekil 3.7. Camsı karbon çalışma elektrodu

Çalışma elektrotları, yarıçaplarına göre makro, mikro ve ultra mikro olmak üzere üç farklı grupta sınıflandırılabilir. Makro elektrotların boyutları 3 cm², mikro elektrotların 1 cm² civarında ve ultra mikro elektrotların ise 20 μ m'den küçüktür. Elektrot yüzey alanı; reaksiyon süresinin daha kısa olabilmesi için preparatif elektrolizde büyük, polarizasyonu sağlamak için de voltametrik çalışmalarda küçük tutulmalıdır.

Yapılan çalışmalarda çalışma elektrotunun özellikleri ve morfolojisinin iyi bilinmesi yapılan çalışmaların tanımlanması ve karakterizasyonların yapılabilmesi için önemlidir. Bu amaçla, elektrokimyasal çalışmalarda yüksek pozitif potansiyel aralığına (2,0 V) sahip olan cam veya kuvartz üzerine buhar depozisyonu ile biriktirilen indiyum kalay oksit (ITO) elektrot çalışma elektrodu olarak kullanılmıştır.



Şekil 3.8. İndium kalay oksit (ITO)

İndiyum kalay oksit elektriksel iletken ve optik geçirgen ince film kaplama çeşitidir. Oda sıcaklığında biriktirilen indiyum kalay oksit (ITO) filmler amorf yapıya sahiptir. Güneş pillerinde, elektrokromik camlarda, LCD ekranlarda, ve ısı bariyerleri olarak kullanılmaktadır. ITO kaplamalar 1.3x10-4 ohm.cm'den düşük özdirence sahip olup görünür bölgede ışık geçirgenliği %85 den yüksektir.

Çalışmalarımızda kullanılan ITO elektrotlar %99,8'lik etanol ve distile su içerisinde sırayla 15 dakika sonike edilerek temizlenmiş N₂ gazı ile kurutularak elektrokimyasal depozisyon işlemi için hazırlanmıştır.

3.1.2. Grafit oksitin sentezi

Grafit oksit (GO) Sreeprasad vd (2009) tarafından bildirilen ve modifiye Hummer metodu (1958) olarak bilinen yöntemle grafit tozundan çıkılarak iki aşamada sentezlenmiştir. GO sentezinde ilk aşamada ön oksitlenmiş (pre-okside) grafit oluşumu gerçekleşirken, ikinci aşama sonrasında tamamen oksitlenmiş grafit oksit elde edilmektedir. Ön oksidasyon aşamasında; 3 g grafit tozu 80°C'de bekletilen 12,5 mL konsantre H₂SO₄, 2,5 g P₂O₅ ve 2,5 g K₂S₂O₈ karışımına eklendi. Karışım 80°C'de 4-5 saat tutuldu. 5 saat sonra karışıma 0,5 L saf su eklendi. Bir gece bekletildi, süzüldü ve hava atmosferinde kurutuldu. Elde edilen katı ön oksitlenmiş grafit tozudur.

Ön oksitlenmiş grafit tozu iyice kurutulduktan sonra 0°C su banyosunda bekletilen 115 mL konsantre H₂SO₄ içine eklendi. Karışıma KMnO₄ (6g) reaksiyonun sıcaklığının 10°C'nin üzerine çıkmamasına dikkat edilecek şekilde eklendi. KMnO₄ ilavesi tamamlandıktan sonra reaksiyonun sıcaklığı 35°C'ye çıkartıldı ve bu sıcaklıkta 2 saat bekletildi. 2 saatin sonunda sıcaklığın 50°C'yi aşmamasına dikkat edilerek 100 mL destile su eklendi. 35°C'de 2 saat daha bekletilen karışıma 300 mL daha destile su ve 5 mL %30'luk H₂O₂ eklendi. Bir gece bekletildi. Üstte biriken süpernetant sıvısı dekante edildi, geri kalan katı kısım süzüldü, %10'luk HCl çözeltisi ve destile su ile birkaç kez yıkandı. Elde edilen katı hava atmosferinde kurutulduktan sonra ağırlıkça %2 olacak

şekilde sulandırılarak metal içeriklerinin giderilmesi için 3 hafta diyalizde bekletildi. GO sentezi Şekil 3.9'da şematik olarak özetlenmiştir.



Şekil 3.9. GO sentezinin şematik özeti.

3.1.3. Kimyasallar

Yapılan çalışmada kullanılan kimyasalların listesi aşağıda verilmiştir.

i. Grafit tozu (325 mesh, %99,9995, Alfa Aesar marka)
ii. Sülfürik asit (H₂SO₄) (Sigma-Aldrich)
iii. Potasyum persülfat (K₂S₂O₈) (Sigma-Aldrich)
iv. Difosfor penta oksit (P₂O₅) (Sigma-Aldrich)
v. Potasyum permanganat (KMnO₄) (Sigma-Aldrich)
vi. Hidrojen peroksit (H₂O₂) (Sigma-Aldrich)
vii. Hidroklorik asit (HCl) (Sigma-Aldrich)
viii. Nitrik asit (HNO₃) (Sigma-Aldrich)
ix. Potasyum nitrat (KNO₃) (Sigma-Aldrich)
x. Titanyum oksisülfat (TiOSO₄) (Sigma-Aldrich)
xi. Titanyum klorür (TiCl₃) (Sigma-Aldrich)

3.1.4. Potansiyostat

Potansiyometre (potansiyostat), potansiyel ölçümünde kullanılan klasik bir cihazdır. Johann Christian Poggendorff (1796-1877) tarafından 1841 yılında icat edilmiş ve standart bir laboratuvar ölçüm tekniği hâline gelmiştir. Elektrokimyasal analizlerde, tayini yapılmak istenen numuneye ait indirgenme veya yükseltgenme akımı ölçülür. Elde edilen bu akım sinyal işlemciye ulaşır ve eğer akım değeri düşükse bir yükseltici (amplifier) vasıtasıyla artırılır. Elektrokimyasal analiz cihazı (potansiyostat), referans elektrota karşın çalışma elektrotunun potansiyelini ayarlayan ve özellikle potansiyel kontrollü elektroliz için kullanılan elektronik bir aygıttır. Şekil 3.10'da bu elektrokimyasal düzenek şematik olarak gösterilmektedir. Bir potansiyostat cihazının temel bileşenleri voltmetre, çalışma elektrodu, karşıt elektrot ve referans elektrottur. Ayrıca bu potansiyostatlar yardımıyla dönüşümlü voltametri, doğrusal taramalı voltametri, kronoamperometri, polarografi, potansiyel kontrollü kulometri ve potansiyel kontrollü elektroliz gibi değişik teknikler kullanılarak kalitatif ve kantitatif analizler yapılabilir. Tez kapsamındaki elektrokimyasal çalışmalarda, (Bioanalytical Systems) BAS100W Electrochemical Workstation marka işlemsel yükseltgeçli elektrokimyasal analizör kullanıldı.



Şekil 3.10. Bir potansiyostat düzeneği ve BAS100W elektrokimyasal analizörü

3.1.5. Tavlama işlemi

Metal oksit sentezinde en önemli aşamalardan birisi ara reaksiyonda oluşan metal hidroksit türlerinin ısıl işleme tabi tutulması kısmıdır. Metal hidroksit türü ısıtıldığında adsorplanmış su yapıdan uzaklaşır ve buna bağlı olarak sentezlenmek istenen metal oksit eğer amorf özellikte ise kristalleşebilir. Ayrıca metal oksit filmi farklı kristal yapılarına sahip ise tavlama ortam sıcaklığı ayarlanırsa kristal formları arasında geçiş yapılabilir. TiO₂'in iki kristal yapısı olan anataz ve rutile yapıları tavlama sıcaklığından etkilenmekte ve birbirine dönüşebilmektedir. Anataz fazı yaklaşık 400°C sıcaklıkta elde edilirken, rutile fazının sentezinin 400°C-1200°C sıcaklıkta oluştuğu bildirilmiştir

(Hanaor and Sorrell 2011). Şekil 3.11'de elektrokimyasal olarak sentezlenen TiO₂ ve TiO₂-ERGO kompozit yapılarının tavlanması için kullanılan tavlama fırının resmi verilmiştir.



Şekil 3.11. Tavlama fırını resmi

Tavlama firininda iç sıcaklık ve firin sıcaklığını gösteren göstergeler mevcut olup, sistemden N_2 veya O_2 gazı geçirilerek tavlama işlemi yapılabilmektedir. Deneylerimizde ITO eletrot yüzeyinde sentezlenen TiO₂ ve TiO₂-ERGO kompozitleri hava ortamında 400°C'de 2 saat süre ile tavlama yapılmıştır.

3.2. Yöntemler

3.2.1. Dönüşümlü voltametri

Voltametri tekniği analitik kimyada ve değişik endüstriyel süreçlerde kullanılan bir elektroanalitik metot olup, bir çalışma elektrotunun polarize olduğu şartlar altında potansiyel uygulandığında elektrotta meydana gelen akımın ölçülmesiyle analit hakkında bilgi edinilen bir grup yöntemi kapsar. Voltametri, elektrokimyasal reaksiyonlarla ilgili kalitatif bilgilerin aydınlatılmasında kullanılan en yaygın tekniktir.

Klasik elektrokimyasal yöntemler icinde en tanınmış olanı polarografi olmasına rağmen son yıllarda en büyük gelişmeyi dönüşümlü voltametri göstermiştir. Bunun sebebi; deneysel şartların hem ucuz hem de her yerde gerçekleştirilebilir olmasıdır. Diğer bir avantajı ise çeşitli ortamlarda meydana gelen yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarının incelenmesi, yüzeydeki adsorbsiyon olaylarının araştırılması ve kimyasal olarak modifiye edilen elektrot yüzeylerinde cereyan eden elektron aktarım mekanizmalarının aydınlatılması gibi reaksiyon hakkında tüm verilerin bu deneyler sonucu elde edilebilmesidir. Dönüşümlü voltamogramlardan; redoks prosesleri, termodinamik veriler, elektron transferi ve sonrasında gelen kimyasal reaksiyonlar hakkında bilgi elde edilebilir. Bu yüzden dönüşümlü voltametriye elektrokimyasal spektroskopi de denir. Voltametride elektrokimyasal hücreye değiştirilebilen potansiyel uyarma sinyalleri uygulanır ve bu uyarma sinyalleri, yönteme göre karakteristik akım oluşturur. Dönüşümlü voltametride, çalışma elektroduna önce E₁ potansiyelinden E₂ potansiyeline sonra tekrar E_1 potansiyeline olacak sekilde zamana bağlı olarak potansiyel sinyali gönderilir ve elde edilen potansiyel zaman diyagramı kaydedilir. Elektrokimyasal reaksiyon sonucu, çalışma elektrodunda oluşan akıma karşı, çalışma elektrotunun potansiyelinin grafiği voltamogramı verir. Çalışma elektroduna verilen potansiyel belirli bir alan içinde hem ileri hem de geriye doğru olabilir ve bu esnada elektrotta meydana gelen akım ölçülür. Bunun için "potansiyostat" adı verilen potansiyel tarayıcı cihaz kullanılır.

Elde edilen voltamogramların şekli elektrot yüzeyinde meydana gelen reaksiyonun tersinir ya da tersinmez olmasına bağlı olarak değişik şekiller almaktadır. Voltamogramlar; dönüşümlü, dönüşümsüz ya da yarı dönüşümlü (önce elektron transferi daha sonrada kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği EC tipi dönüşümlü) olabilir (Şekil3.12). Genel olarak elektron transfer hızı, kütle transfer hızı ve elektrotta meydana gelen reaksiyonlar bir voltamogramın şeklini belirleyici unsurlardır.



Şekil 3.12. Dönüşümlü, dönüşümsüz ve yarı dönüşümlü voltamogramlar

Şekil 3.12'deki dönüşümlü voltamogram için; eğer yükseltgenen madde kimyasal bir reaksiyona girmemiş ise pik potansiyelinin aşılmasından kısa bir süre sonra 57 mV'luk bir kayma ile ikinci ters yönlü pik oluşur. Bu durumda pik yükseklikleri eşit olmaktadır. Potansiyel değişim hızı yükseldiğinde, bu pik arasındaki potansiyel farkı yükselecek pik arası mesafe artacaktır. Pik yüksekliği konsantrasyona, difüzyon sabitine ve potansiyel tarama hızına bağlıdır. Yalnız, difüzyon ile yük geçişi karşılaştırılabilirse tarama hızına olan bağımlılık ihmal edilebilecek kadar küçük olur. Yük geçişinin hızlı olduğu durumlarda pik potansiyeli, tarama hızına bağlı olarak değişiklik gösterir, ileri ve geri yöndeki piklerin karşılaştırılması sonucu elektrotlarda gerçekleşen reaksiyonların kinetik parametreleri hakkında fikir edinilebilir. Özellikle reaksiyonu tersinirliliği hakkında önemli bilgiler sunan dönüşümlü voltametri, reaksiyon mekanizmasının tayininde de kullanılmaktadır. Bu tez kapsamında grafit oksitin elektrokimyasal indirgenmesi ve TiO₂ nanoyapılarının elektrokimyasal sentezi için dönüşümlü voltametri tekniği kullanıldı.
3.2.2. Karakterizasyon yöntemleri

3.2.2.a. X-Işını fotoelektron spektroskopisi (XPS)

Bir yüzey analiz yöntemi olan X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) 1981 yılında fizik dalında Nobel ödülü kazanan K. Siegbahn tarafından geliştirilmiştir. XPS tekniği kimyasal analiz için elektron spektroskopisi (ESCA) olarak da adlandırılmaktadır. XPS, yüzey atomlarının iç kabuklarındaki (core level) enerji seviyelerinde bulunan elektronların fotoelektrik olay sonucu uyarılması mantığına dayanır (Şekil 3.13). Basitçe, fotoelektrik olay sebebiyle belli bir enerjiyle uyarılan elektronların kinetik enerjileri bilinirse bağlanma enerjileri de hesaplanabilir. İç kabuklardan uyarılan ve fotoelektron adı verilen elektronların kinetik enerjilerinden yola çıkarak Einstein prensibince bağlanma enerjileri (binding energy) hesap edilip, spektrumlar elde edilebilir. XPS yöntemi, numunenin yüzeyi hakkında nitel ve nicel bilgiler vermekle kalmaz aynı zamanda incelenen elementin bileşik yapısı ve elementlerin yükseltgenme basamağı hakkında da fikirler verir. Alınan XPS spektrumundaki tepelerin (pik) enerjileri tespit edilerek numunenin hangi atomları içerdiği bulunabilir. Hatta, Si⁰ ve Si^{4+,}'da olduğu gibi farklı değerliğe sahip atomların dahi ayrılması mümkündür. Ayrıca, tepe alanları karşılaştırılarak nicel bilgi elde etmek de mümkündür.



Şekil 3.13. XPS yönteminin temel prensibi

X-ışını absorbsiyon ve X-ışını fotoelektron spektroskopilerinin her ikisi de,

$$A + h \upsilon \rightarrow A^{+*} + e^{-} \tag{3.4}$$

denklemine göre çalışırlar. Birincisinde, örnek bir polikromatik kaynak ile ışınlandırılır. Absorblanan ışının miktarı, dalga boyunun veya enerjinin bir fonksiyonu olarak incelenir; bunun için bir X-ışını spektrometresi kullanılır. İkincisinde kaynak bir monokromatik ışındır ve çıkan elektronun enerjisi bir elektron spektrometresi ile ölçülür. Çıkan elektronun kinetik enerjisi Ek, elektronun bağlanma enerjisinin hesaplanmasında kullanılır:

$$\mathbf{E}_{\mathbf{b}} = \mathbf{h} \,\upsilon - \mathbf{E}\mathbf{k} \tag{3.5}$$

Bağlanma enerjisi her elementin her elektronu için özeldir ve bu nedenle de elementi tanımlamada kullanılan bir parametredir. XPS cihazının çalışma prensibi Şekil 3.14'da gösterilmiştir.



Şekil 3.14. XPS spektrumu oluşumunun şematik gösterimi

XPS spektroskopisi ile bir yüzeydeki atomların birbirine oranı deneysel olarak hesaplanabilir. Bu oran, teorik olarak hesaplanan oran ile karşılaştırılmak suretiyle, modifiye yüzeyin elde edilip edilemediği hakkında fikir verebilir. Deneysel oran hesabı için kıyaslanacak atomların bağlanma enerjisi bölgesi XPS ile taranıp, fit programları ile pik bölgesi altındaki alanlar hesaplanarak elementler arası bir oran elde edilebilir. Kompozit malzemelerin karakterizasyonunda metal atomlarının metalik formda bulunmasının tespiti ve grafen oksitin indirgenmesindeki fonksiyonel grupların yüzdesel dağılımlarındaki değişikliğin kontrolü için XPS spektrumu kullanılmıştır.

3.2.2.b. X-ışınları kırınımı (XRD)

X-ışınları kırınımı basit inorganik katılardan, DNA ve proteinler gibi daha karmaşık yapıdaki molekülleri içeren materyallerin kristal yapıları, kristaldeki atom düzlemleri arasındaki uzaklık, kristal boyutu ve kusurları, kimyasal bileşimleri, fiziksel özellikleri

ve faz yapıları hakkında bilgi veren analitik bir tekniktir. Kristal atomlarının geometrik düzeni ve aralarındaki mesafe hakkındaki çoğu bilgiyi sağladığından dolayı XRD kristal yapıdaki bileşiklerin kalitatif olarak tanınmasında pratik ve uygun bir yöntemdir. XRD'nin çalışma prensibinin temeli, numune ile etkileşerek yansıyan ve kırılan Xışınlarına ait verilerin toplanmasına dayanır.

XRD cihazında X-ışınları kaynağı olarak X-ışını tüpleri kullanılmaktadır. Dalga boyu sabit X-ışınları elde etmek için, ısıtılan bir tungsten filamandan ısı tahriki ile yayınlanan elektronlar elektromanyetik bir alan içinde hızlandırılır. Bir yarıktan geçirildikten sonra paralel olan X-ışınları, daha sonra dönebilen bir kristal düzlemine gelir (Şekil 3.15). Kırınım yüzeysel bir olay değildir yani kristal yüzeyinin altındaki atom düzlemlerine de X-ışınları ulaşmaktadır. X-ışınları demeti düzensiz yapıda (amorf) bir kristal düzlemine çarparsa, taneciklerin düzensizliğinden kristal düzlemlerinden yansıyan X-ışınlarının aldıkları yolların uzunlukları farklı olur, ışınlar birbirlerini söndürürler ve kırınım gerçekleşmez. Bu durumun sonucu olarak kristale ait kırınım piki gözlenmez.



Şekil 3.15. XRD cihazının çalışma prensibi

XRD çalışmalarında, dalga boyu aralığı; 10⁻⁵-10² Å aralığında olan monokromatik Xışınları X-ışını tüpleri kullanılarak elde edilir (Şekil 3.16). Dalga boyu sabit X-ışınları elde etmek için, ısıtılan bir katot (tungsten gibi) filamandan ısı tahriki ile yayınlanan elektronlar 100 kV'luk elektromanyetik bir alan içinde hızlandırılır. Hareket eden yüklü parçacıklar aniden durdurulduğunda, kinetik enerji kayıpları ile uyumlu fotonlar yayınlarlar. Yüksek enerjili elektronlar bir anota (bakır gibi) hedefe çarptırılırlarsa, enerjilerini kaybederek X-ışınları bölgesinde sürekli radyasyon yayınlarlar. Yayınlanan enerji, aşağıdaki eşitlik ile verilir.

$$E=hc/\lambda$$
 (3.6)

Burada; h: Planck sabiti (6,62x10⁻³⁴ J.s), c: ışık hızı (3x10⁸ m/s), λ ise X-ışınının dalga boyudur.



Şekil 3.16. Bir X-ışını tüpü

Bragg kanunu olarak bilinen;

$$2d\,\sin\theta = n\,\lambda\tag{3.7}$$

bağıntısı sayesinde kristalde bulunan atom düzlemleri arasındaki mesafe kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Bu denklemde; θ Bragg açısı (gelen ışınlarla atom düzlemlerinin yaptığı açı) ve λ (kullanılan x-ışınının dalga boyu) bilinirse d (atom düzlemleri arasındaki uzaklık) hesaplanabilir. Bunun dışındaki tüm açılarda olumsuz girişim meydana gelir. Kristal yapı analiz çalışmaları, Cu-K α (λ =1,5405 Å) kaynaklı, Rigaku-2200 D/Max. marka X-ışınları difraktometresi ile yapıldı.

Bu tez kapsamında XRD tekniği elektrokimyasal olarak sentezlenen TiO_2 ve TiO_2 -ERGO kompozit yapılarının kristal analizini aydınlatmak için kullanılmıştır.

3.2.2.c. Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

Elektrokimyasal olarak biriktirilen malzemenin morfolojisini, 2 boyutlu çekirdekleşme ve büyüme kinetiğini tartışabilmek için STM, AFM, SEM ve TEM gibi görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. SEM tekniği film kalınlığının önemi olmaksızın, temel olarak malzemenin yüzeyinde küçük bir noktaya gönderilen elektron demetleri yardımıyla yüzeyden saçılan ikincil elektron sinyallerini algılayarak numunenin bileşimi, kristallografik özellikleri, morfolojik ve topografik yapısı hakkında bilgi verir (Şekil 3.17).



Şekil 3.17. SEM cihazının çalışma prensibi

Yüksek voltajda ivmelendirilen elektron demeti ile numune arasındaki etkileşimleri incelendiğinde, yüksek enerjili demet elektronları numune atomlarının dış yörünge elektronları ile elastik olmayan girişimi sonucunda düşük enerjili Auger elektronları oluşur. Bu elektronlar numune yüzeyi hakkında bilgi taşır ve Auger Spektroskopisinin çalışma prensibini oluşturur. Yine yörünge elektronları ile olan girişimler sonucunda yörüngelerinden atılan veya enerjisi azalan demet elektronları numune yüzeyine doğru hareket ederek yüzeyde toplanırlar. Bu elektronlar ikincil elektron (seconder electrons) olarak tanımlanır. İkincil elektronlar numune odasında bulunan sintilatörde toplanarak ikincil elektron görüntüsü sinyaline çevrilir. İkincil elektronlar numune yüzeyinin 10 nm veya daha düşük derinlikten geldiği için numunenin yüksek çözünürlüğe sahip topografik görüntüsünün elde edilmesinde kullanılır.

Taramalı elektron mikroskobu metal, seramik, kompozit, polimer, kaplama ya da ince film malzemelerin yüzey ve kesit görüntülerinin incelenmesinde, toz numunelerin parçacık boyut ve şekillerini karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.

3.2.2.d. Enerji dağılımlı spektroskopi (EDS)

EDS tekniği sayesinde numune yüzeyinin kalitatif ve kantitatif tayini yapılabilmekte ve numune içerisinde istenmeyen elementlerin varlığı tespit edilebilmektedir. EDS analizleri genellikle SEM cihazına adapte edilen aparat ile kombinlenmiştir. Numune yüzeyine gönderilen yüksek enerjili elektronlar numune ile etkileştiğinde, yüzeyden geri saçılmış elektronlar, Auger elektronları, ikincil elektronlar, X-ışını emisyonu ve değişik enerjili diğer fotonlar oluşur. Bu elektron türlerinden geri saçılmış ve ikincil e⁻'lar SEM'in temelini oluşturur. EDS'in temeli ise elektron bombardımanına maruz bırakılan numuneden elektronlarla numunenin etkileşimi sonucunda salınan X-ışının çözümlenmesine dayanır. Periyodik tablodaki her bir elementin farklı elektronik yapıya sahip olmasının bir sonucu olarak her element elektronik dalgalara farklı bir cevap verecek ve her bir element için salınan ışınların enerjisi farklı olacaktır. Karakterizasyon yeteneği yüksek olan bu teknik mevcut elementlerin oranını da verir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

4.1. TiO₂'in Katodik Depozisyonu

TiO₂'in katodik depozisyonunda öncelikle kullanılan Ti metal tuzunun etkisi araştırıldı. Bu amaçla TiCl₃ ve TiOSO₄ tuzları ile dönüşümlü voltamogramlar alındı. TiO₂ filminin elektrokimyasal olarak depozisyonu için ortamda nitrat iyonlarının da bulunması gerekir. 25 mM TiCl₃, 0,1 M KNO₃ ve 0,5 M HCl'ten oluşan elektrolit ortamında ITO elektrodun dönüşümlü voltamogramı Şekil 4.1'de gösterilmiştir.



Şekil 4.1. TiCl₃ çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan dönüşümlü voltamogram

TiCl₃ tuzu kullanılarak yapılan katodik depozisyonda yaklaşık -860 mV ve -1100 mV'ta iki indirgenme piki görülmektedir. Bu katodik piklerden -860 mV bölgesindeki pik ITO substrat yüzeyinde öncelikle sulu ortamda NO_3^- iyonlarının NO_2^- iyonlarına indirgenmesine karşılık gelmektedir (Reaksiyon 4.1). Bu indirgenmeye ait reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

$$\mathrm{Ti}^{3+} + \mathrm{NO}_{3}^{-} \rightarrow \mathrm{TiO}_{2}^{+} + \mathrm{NO}_{2} \tag{4.1}$$

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2 \tag{4.2}$$

Daha negatif potansiyel bölgesine gidildiğinde eş zamanlı olarak NO₃⁻ iyonlarının OH⁻ iyonu vermek üzere parçalanması ve Ti⁺³ ile NO₃⁻ arasındaki reaksiyondan oluşan TiO⁺² türünün elektrot yüzeyine gelişinden kaynaklanan-1100 mV'ta yayvan bir indirgenme piki görülmüştür (Huang *et al.* 2010). TiO(OH)₂ oluşumu geri dönüşümsüz bir prosestir. Bu aşamadaki reaksiyonlar:

$$2NO_2^- + 4H_2O + 6e^- \rightarrow N_2 + 8OH^-$$
 (4.3)

$$N_2 + 8H_2O + 6e^- \rightarrow 2NH_4^+ + 8OH^-$$
 (4.4)

$$\operatorname{TiO}^{2+} + 2\operatorname{OH}^{-} + x\operatorname{H}_2\operatorname{O} \to \operatorname{TiO}(\operatorname{OH})_2 \cdot x\operatorname{H}_2\operatorname{O}$$

$$(4.5)$$

Elektrot yüzeyine biriken $TiO(OH)_2$ jelimsi yapısı ısıl işleme tabi tutulduğunda kolaylıkla TiO_2 vermek üzere parçalanabilir. TiO_2 'in katodik depoizsyon işlemi bu jel aşamasında sonlandırılır.

Ti kaynağı olarak TiOSO₄ tuzu kullanıldığında H_2O_2 'in çözelti içerisine ilave edilmesi ile titanyum tuzunun öncelikle kimyasal olarak oksidasyonu sağlanır ve Ti(O₂)SO₄ ara ürünü oluşur (Reaksiyon 4.6). NO₃⁻ ise çözeltide hidroksit OH⁻ iyonlarını oluşturacak şekilde indirgenir (Reaksiyon 4.7). Ti(O₂)SO₄ ara ürünü ile NO₃⁻ tan gelen OH⁻ iyonları tepkimeye girer ve TiCl₃ ortamında olduğu gibi TiO(OH)₂ formuna dönüşür (Reaksiyon 4.8). Sonrasında bu ürünün hidrolizi ile TiO₂ elde edilir (Reaksiyon 4.9).

$$TiOSO_4 + H_2O_2 \rightarrow Ti(O_2)SO_4 + H_2O$$
(4.6)

$$NO_3^- + H_2O + 2e^- \rightarrow NO_2^- + 2OH^-$$

$$(4.7)$$

$$Ti(O_2)SO_4 + 2OH^- + (x+1)H_2O \rightarrow TiO(OH)_2. xH_2O + H_2O_2 + SO_4^{2-}$$
 (4.8)

$$TiO(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} TiO_2 + H_2O \tag{4.9}$$

Şekil 4.2. 0,04M TiOSO₄, 0,1M KNO₃ ve 0,2M H_2O_2 çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında ITO elektrodun dönüşümlü voltamogramı.

TiOSO₄ çözeltisi içerisinde ITO elektrot ile alınan voltamogram Şekil 4.2'de verilmiştir. Bu voltamogramda TiCl₃ çözeltisi içerisinde alınandan farklı olarak yaklaşık -1000 mV'ta tek pik görülmüştür. Bu pik NO_3^- iyonunun elektron alış-verişi ile indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. (Karuppuchamy *et al.* 2002). TiOSO₄ tuzundan TiO₂ elde edilirken çözelti ortamında renk değişikliği meydana geldi. Daha önce literatürde belirtildiği gibi TiOSO₄ çözeltisine NO_3^- ilave edildiğinde önce renk beyaz olmakta asit ilavesi ile renk turuncu-beyaz renge dönüşmektedir (Karuppuchamy *et al.* 2002). Çözeltilerimizin renk değişimi Şekil 4.3'te resim olarak gösterilmiştir.



Şekil 4.3. TiOSO4 çözeltisinde meydana gelen renk değişimi

 TiO_2 'in katodik depozisyonunda kullanılabilecek $TiCl_3$ ve $TiOSO_4$ tuzlarının her ikisi için de -1000 mV'tan sonra elektrokimyasal depozisyonun yapılabileceği görülmüştür. $TiCl_3$ tuzundan zamanla Cl_2 gazı oluşumundan dolayı tuz bileşimi değiştiği için deneylere $TiOSO_4$ tuzu ile devam edilmiştir.

4.2. TiO₂/ERGO Nanokompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi

GO'in elektrokimyasal indirgenmesi daha önce grubumuz tarafından Au (111) elektrot kullanılarak başarıyla gerçekleştirilmiştir (Doğan *et al.* 2013). Au elektrot yüzeyinde GO süspansiyonunda yapılan voltametrik incelemelerde GO'teki farklı oksijen içeren fonksiyonel gruplarının tamamının yüzeyden uzaklaştırılabilmesi için -0,9 V (Ag/AgCl referans) potansiyel değerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Deneylerimizde ERGO yapısının sentezi 1 mg/mL GO içeren 0,1 M KNO₃ çözeltisinde dönüşümlü voltametri tekniği ile gerçekleştirildi (Şekil 4.4). ITO elektrot yüzeyinde GO'in elektrokimyasal indirgenmesi için alınan voltamograma göre -1000 mV potansiyel değerinde GO yapısı ERGO'e indirgenebilir.



Şekil 4.4. ITO elektrodun GO çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan dönüşümlü voltamogramı

TiO₂-ERGO nanokompozitlerinin elektrokimyasal sentezi için öncelikle TiOSO₄, H₂O₂ ve KNO₃ çözeltisi ile GO çözeltisi karıştırıldı. Karışım çözeltisine tek potansiyel uygulanarak kompozit filminin elektrot yüzeyinde depozit olması sağlandı. TiOSO₄ ile GO karışım çözeltisinde alınan dönüşümlü voltamogram Şekil 4.5'te verilmiştir.



Şekil 4.5. TiOSO₄ ile GO karışım çözeltisinde 100 mV/s tarama hızında alınan dönüşümlü voltamogram

Şekil 4.4'teki voltamograma göre karışımda gözlenen pikin potansiyeli, sadece TiOSO₄ ortamında alınandan voltomogram pik potansiyelinden yaklaşık 200 mV daha pozitife kaymıştır. Bu kayma GO ile TiOSO₄ karıştırıldığında GO'teki oksijen içeren fonksiyonel grupların varlığından dolayı çözeltinin pH'sında meydana gelen kaymadan kaynaklanabilir. Karışım ortamındaki voltamogramdan TiO₂-ERGO nanokompozitlerinin sentezi -1100 mV sabit potansiyelin 2 saat süreyle uygulanması ile gerçekleştirildi.

4.3. TiO₂ Filmlerinin Yapısal ve Morfolojik Karakterizasyonu

4.3.1. TiO₂ filmlerinin yapısal karakterizasyonu

TiO₂ filmlerinin SEM, XRD, EDS ve XPS teknikleri kullanılarak analitik ve morfolojik karakterizasyonu yapılmıştır. Karakterizasyon işlemlerinde sentezlenen filmler için Ti ve oksijen yapısına ait karakteristik pikler araştırılmıştır.

TiO₂ filmlerinin yapısal karakterizasyonu için öncelikle kristal yapısının aydınlatılması amacıyla XRD spektrumu alınmıştır. TiO₂ filmlerinin ısıl işleme tabi tutulmasına bağlı olarak kristal yapılarında değişiklik olduğu bilindiğinden, tavlama öncesi ve tavlama sonrası XRD spektrumlarında meydana gelen değişikler incelenmiştir. Tavlama öncesi alınan XRD spektrumunda substrat olan ITO yapısına ait 31°, 35°, 50° ve 61° derecede ki pikler baskın olarak gözlenmiş herhangi bir TiO₂ kristal yapısı tespit edilememiştir (Şekil 4.6.a). Tavlama sonrasında özellikle yaklaşık 25° ve 55°'lerde gözlenen kırınım pikleri(Şekil 4.6.b) TiO₂'in anataz kristal yapılarına karşılık gelmektedir.(JCPDS card no. 71-1166) (Şekil 4.6.b). XRD spektrumunda gözlenen piklerden faydalanılarak Scherrer denklemi sayesinde kristal boyutu ölçülebilir (Mao *et al.* 2014).Bu denklem:

$$d = \frac{0.9\,\lambda}{\beta \frac{1}{2}\cos\theta} \tag{4.10}$$

Bu denklemde d ortalama partikül boyutu (nm), λ X ışını kaynağı olarak kullanılan ışığın dalga boyu (1,5418 Å), $\beta_{1/2}$ kırınım pikinin yarı pik genişliğinin θ cinsinden açı değeridir. Scherrer eşitliği kullanılarak TiO₂ kristallerinin boyutu hesaplanmıştır. 25° kırınım piki için partikül boyutu 29,5 nm olarak belirlenirken, 55° kırınım piki için ise 47,8 nm olarak ölçülmüştür.



Şekil 4.6. TiO₂ ince filmlerinin a) tavlama öncesi b) tavlama sonrası XRD spektrumları

Aynı ortam şartların da (çözelti, potansiyel, sıcaklık, pH, substrat, tavlama sıcaklığı ve süresi) farklı sürelerde elektrokimyasal olarak sentezlenen TiO_2 filmi için XRD spektrumu alınmıştır (Şekil 4.7). Bu spektrumda depozisyon süresi arttıkça 25°'deki anataz TiO_2 kırınım pik şiddetinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç anataz- TiO_2 filminin elektrodepozisyonunda zamanın etkileyici bir faktör olduğunu ispatlamaktadır.



Şekil 4.7. Farklı sürelerde depozit edilen TiO₂ filmlerinin XRD spektrumları a) 10 saat b) 3 saat.

TiO₂ filmlerindeki titanyum ve oksijen elementlerinin bağlanma enerjisi kullanılarak oksit filmin yapısal karakterizasyonu araştırılmıştır. -1100 mV'ta 2 saat süreyle elektrokimyasal olarak depozit edilmiş ve sonrasında 400°C'de 2 saat süreyle tavlanmış TiO₂ filmine ait XPS spektrumu Şekil 4.8'de gösterilmiştir. Geniş ölçekli alınan spektrumda substrat olarak kullanılan ITO'ya ait pikler ile TiO₂'ten kaynaklanan Ti2p_{1/2} (464,1 eV), Ti2p_{3/2} (458,5 eV) ve O1s (529,9 eV) pikleri gözlenmiştir. Metal oksit yapısındaki Ti ve O elementlerinin oksidasyon derecelerinin belirlenmesi için XPS bölgeleri ayrıca açık olarak Şekil 4.9 ve Şekil 4.10'da verilmiştir.



Şekil 4.8. TiO₂ filminin XPS spektrumu

Şekil 4.9'da Ti elementinin 2p enerji bölgesine ait spektrumda pik gözlenir. Bu pik 458,5 eV bağlanma enerjilerinde ortaya çıkar. Ti $2p_{3/2}$ elektronları için gözlenen bu eV değeri Ti⁺⁴ oksidasyon basamağındaki fotoelektronlarına karşılık gelir (Wang *et al.* 2012).



Şekil 4.9. Ti 2p orbital elektronlarının XPS spektrumu

TiO₂ filmindeki O 1s bölgesi için alınan XPS spektrumunda, oksijen elementinin metal oksit formunda bulunmasına karşılık gelen 530 eV değerinde tek bir pik gözlendi (Şekil 4.10). TiO₂'in oluşumu esnasında ara ürün olarak meydana gelen TiO(OH)₂ yapısından kaynaklı herhangi bir hidroksil (-OH) grubuna ait pik gözlenmemiştir. Bu durum tavlama işlemi ile bütün TiO(OH)₂ yapılarının TiO₂'e dönüştüğünü ifade etmektedir.



Şekil 4.10. O1s orbital elektronunun XPS spektrumu

 TiO_2 filminin yapısal olarak safsızlık içermediğinin ve stokiyometrik bileşiminin belirlenmesi için EDS spektrumu alınmıştır (Şekil 4.11). Bu spektrumda Ti, O ve substrat olan ITO'dan kaynaklanan piklerden başka herhangi bir elemente ait pik gözlenmemiştir. Bu durum elementel boyutta saf TiO₂ filmlerinin oluşumunu desteklemektedir. Element bileşimlerine bakıldığında ise substrat olarak kullanılan indiyum kalay oksitten gelen oksijenden dolayı Ti'un O'e göre oranı küçük çıkmıştır.



Şekil 4.11. TiO₂ filminin EDS spektrumu

TiO₂ filmlerinin yapısal karakterizasyonunda, TiOSO₄ içeren çözelti ortamında 2 saat -1100 mV sabit potansiyel uygulandığında ve 400°C'de 2 saat tavlama yapıldığında elektrot malzemesi yüzeyinde saf TiO₂ ince filmlerinin elde edilebileceği tespit edildi.

4.3.2. TiO₂ fimlerinin morfolojik karakterizasyonu

TiO₂ ince filmlerinin katodik depozisyonu yapıldıktan sonra tavlama öncesi ve tavlama sonrası yüzeyin morfolojik karakterizasyonu SEM tekniği ile gerçekleştirildi. Tavlama öncesine ait SEM görüntüsü incelendiğinde ITO yüzeyinde kabuk şeklinde görünen yapılar tespit edilmiştir (Şekil 4.12). Bu farklı büyüklüklerdeki kabuk yapılarının üçgen ve dikdörtgen gibi farklı büyüme şekillerinde olduğu görülmektedir.



Şekil 4.12. TiO2 filminin tavlama öncesi alınan SEM görüntüsü

TiO₂ filmleri 400°C'de 2 saat ısıl işleme tabi tutulduğunda, tavlama öncesinde gözlenen kabuk yapıları ara form olarak elde edilen TiO(OH)₂ yapısından su kaybettiği için birbirinden uzaklaşmakta, kıvrılmakta ve boyut olarak küçülmektedirler (Şekil 4.13).



Şekil 4.13. TiO₂ filminin tavlama sonrası alınan SEM görüntüsü

4.4. TiO₂-ERGO Kompozitinin Yapısal Karakterizasyonu

ITO substrat yüzeyinde TiO₂ filmlerinin katodik depozisyon şartları belirlendikten sonra GO'in (1 mg/ml) KNO₃ içerisindeki süspansiyonu ile 0,04 M TiOSO₄, 0,1 M KNO₃, 0,2 M H₂O₂ çözeltisi karıştırılmış ve -1100 mV sabit tek bir potansiyel uygulanarak TiO₂-ERGO kompozit filmlerinin elektrot yüzeyine depozisyonu sağlanmıştır. 2 saat depozit edilmiş TiO₂-ERGO kompoziti için de ısıl işlemin etkisi XRD spektrumu alınarak Şekil 4.14'te incelenmiştir.



Şekil 4.14. TiO₂-ERGO kompozitinin tavlama öncesi ve sonrası alınan XRD spektrumları

TiO₂-ERGO kompoziti için alınan XRD spektrumunda, sadece TiO₂ için alınan spektruma benzer şekilde tavlama işleminden sonra anataz yapısına ait kırınım piki gözlenmiş ve kompozit yapıya da TiO₂ gibi ısıl işlem uygulanması gerektiği belirlenmiştir. Kompozitteki ERGO yapısına ait kırınım piki TiO₂'in anataz piki ile çakışık durumdadır. Bu nedenle aynı şartlarda sadece TiO₂ için alınan XRD spektrumu ile TiO₂-ERGO kompozitine ait XRD spektrumu Şekil 4.15'te çakıştırılmıştır. Bu XRD spektrumları karşılaştırıldığında kompozit malzemeye ait yaklaşık 25°'deki kırınım pik şiddeti artmıştır. GO'in elektrokimyasal olarak indirgenmesi sonucunda elde edilen ERGO filminin (002) kristal formundan dolayı pik şiddeti artış göstermiştir.



Şekil 4.15. TiO₂ ve TiO₂-ERGO kompozitinin XRD spektrumları

Kompozit malzeme için alınan XPS spektrumunda, Ti, O ve C pikleri ile substrattan kaynaklanan In piki tespit edilmiştir (Şekil 4.16). Bu spektrum sadece TiO₂ filmi için alınan spektrum ile uyumlu olup Ti bölgesi metal oksit oluşumunu desteklemektedir. TiO₂'den farklı olarak kompozit yapısına dahil olan C piki özel olarak incelenmiştir (Şekil 4.17).



Şekil 4.16. TiO₂-ERGO kompozitinin XPS spektrumu



Şekil 4.17. Kompozit malzeme için C1s bölgesine ait XPS spektrumu

Kompozit malzeme için alınan spektrumda C1s bölgesi incelendiğinde ERGO yapısına ait C1s pikleri 285 eV bölgesinde yer alırken, kompozit malzeme için Ti-C etkileşiminden dolayı bu pikin merkezi 283.7 eV değerine kayar (Akhavan and Ghaderi 2009). Ayrıca C-O etkileşiminden dolayı da 286 eV civarında bir omuz görülmüştür.

TiO₂-ERGO kompozitinin elementel bileşiminin belirlenmesi için alınan EDS spektrumunda ERGO yapısından kaynaklanan C piki ile TiO₂ yapısından gelen Ti ve O pikleri görülmüştür (Şekil 4.18). Elementel boyutta saf kompozit filmleri elektrokimyasal olarak başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Kompozit bileşiminde C'na ait yüzdesel değerin küçük olması XRD spektrumunda ERGO'ya ait pikin tek başına görülememesini desteklemiştir (Oliveira *et al.* 2016).



Şekil 4.18. TiO₂-ERGO kompozitinin EDS spektrumu

4.5. TiO₂-ERGO Kompozitinin Morfolojik Karakterizasyonu

Kompozit filminin yüzey morfolojisinin incelenmesi için öncelikle sadece ERGO yapısının SEM görüntüsü alınmıştır (Şekil 4.19). ERGO filmi ITO substrat yüzeyinde -

1100 mV'ta 30 dakika süre ile depozit edilmiştir. Sadece ERGO'e ait SEM görüntüsünde grafenin literatürde transparan çarşaf yapısı olarak bilinen kıvrımları net olarak görülmüştür. Ayrıca depozit edilen ERGO filminin oldukça ince bir tabaka şeklinde birikmesinden dolayı ITO substratın kristal yüzeyi de görülmektedir.



Şekil 4.19. ITO yüzeyine depozit edilen ERGO filminin SEM görüntüsü

TiO₂-ERGO kompoziti için alınan SEM görüntüsünde hem TiO₂'e ait kabuk şeklindeki yapılar hem de grafene ait çarşaf şeklindeki kıvrımlar görülmüştür (Şekil 4.20). Bu görüntüde grafen yapısı ile TiO₂ yapısı eş zamanlı olarak elektrot yüzeyinde birikmiştir. Kompozit malzemeye ısıl işlem uygulandığı için grafen kıvrımlarına ek olarak TiO₂'nin kabuk yapılarında da kıvrımlar tespit edilmiştir. Bu durum sadece TiO₂ filminde olduğu gibi kompozit yapısındaki suyun uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.



Şekil 4.20. TiO₂-ERGO kompozitine ait SEM görüntüsü

TiO₂ ve TiO₂-ERGO kompoziti için yapılan karakterizasyon işlemleri elektrokimyasal teknik ile bu yapıların başarılı bir şekilde elektrot yüzeyinde biriktirilebileceğini göstermiştir.

5. SONUÇ

ITO elektrot yüzeyinde TiO₂ filmleri elektrokimyasal olarak başarılı bir şekilde sentezlendi. Yapılan çalışmalarda TiO2'in elektrokimyasal depozisyonu için 0,04 M TiOSO₄, 0,1 M KNO₃ ve 0,2 M H₂O₂ çözelti ortamında -1100 mV'ta 2 saat süreyle depozisyonun yapılabileceği belirlendi. GO, ITO elektrot üzerinde GO içeren süspansiyondan doğrudan elektrokimyasal olarak indirgendi. Voltametrik çalışmalarda elektrot yüzeyinde GO türlerinin elektrokimyasal indirgenmesi için -1100 mV potansiyel değerinin uygun olduğu görüldü. ITO elektrotta GO'in elektrokimyasal indirgenme şartının tespitinden sonra, Ti'un indirgenmesi üzerine katkısı incelendi. TiOSO₄-GO karışım çözeltisin de gözlenen pik potansiyelinin, sadece TiOSO₄ ortamında alınan voltomogram pik potansiyelinden yaklaşık 200 mV daha pozitife kaydığı belirlendi. Ti⁺⁴ iyonlarını ve GO'i içeren çözelti ortamında ortak potansiyelde yapılan depozisyon sonucu ITO-TiO₂-ERGO kompozitleri elektrokimyasal olarak sentezlendi. Elde edilen ITO-TiO₂-ERGO kompozit malzemeleri XRD, XPS, EDS, ve SEM teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Özellikle XRD ve XPS teknikleri ile kompozit malzemedeki TiO₂ yapısı tespit edildi. Alınan XRD spektrumunda 25° ve 55° kırınım açılarında TiO2'in anataz kristal yapılarına ait kırınım pikleri görüldü. XRD spektrumundan kompozitteki TiO₂ nanopartiküllerinin boyutu 25° kırınım piki için 29,5 nm olarak belirlenirken, 55° kırınım piki için ise 47,8 nm olarak hesaplandı. Elde edilen TiO₂ filmlerinin 1s1l işleme tabi tutulmadan anataz formuna dönüşemediği tespit edildi. Depozisyon süresinin artışına bağlı olarak yüzeyde daha çok filmin oluşturulabileceği görüldü. Yapılan morfolojik karakterizasyonda TiO₂ filmlerinin tavlama ile daha küçük partiküllere dönüştüğü belirlendi. Kompozit malzemeler için alınan XRD, XPS ve EDS spektrumlarında hem TiO₂ hem de elektrokimyasal indirgenmiş GO (ERGO) yapılarının bulunması elektrokimyasal yöntem ile tek potansiyelde kompozit malzemenin başarılı bir şekilde sentezlenebileceğini gösterdi.

KAYNAKLAR

- Ajayan, P.M., Schadler, L.S., Braun, P.V., 2003. Nanocomposite Science and Technology, Wiley, Newyork, USA.
- Akhavan, O., Ghaderi, E., 2009. Photocatalytic Reduction of Graphene Oxide Nanosheets on TiO2 Thin Film for Photoinactivation of Bacteria in Solar Light Irradiation. J. Phys. Chem. C, 113, 20214–20220.
- Anandan, S., Rao, T.N., Sathish, M., Rangappa, D., Honma, I., 2013. Miyauchi, M., Superhydrophilic Graphene-Loaded TiO2 Thin Film for Self-Cleaning Applications, 5, 207–212.
- Arami, H., Mazloumi, M., Khalifehzadeh, R., Sadrnezhaad, S.K., 2007. Mat. Let, 61, 4559–4561.
- Basirun, W.J., Sookhakian, M., Baradaran, S., Mahmoudian, M.R., Ebadi, M., 2013. Solid-phase electrochemical reduction of graphene oxide films in alkaline solution. Basirun et al. Nanoscale Research Letters, 8, 397.
- Bikkarolla, S.K., Cumpson, P., Joseph, P., Papakonstantinou, P., 2014. Oxygen reduction reaction by electrochemically reduced graphene oxide. Faraday Discussions, 173, 415-428.
- Brinker, C.J., Scherer, G.W., 1990. Sol-gel sicience Acedemic Press, Inc.
- Carp, O., Huisman, C.L., Reller, A., 2004. Photoinduced reactivity of titanium dioxide. Progress in Solid State Chemistry, 32, 33–177.
- Chen, C., Wang, N., Zhou, P., San, H., Wang, K., Chen, X., 2016. Electrochemically Reduced Graphene Oxide on Well-Aligned Titanium Dioxide Nanotube Arrays for Betavoltaic Enhancement. ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 24638–24644.
- Chen, X., Mao, S.S., 2006. Syntefesis of Titanium Dioxide(TiO2) Nanomaterials. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6, 906-925.
- Cromera, D., Herrington, K., 1954. The Structures of Anatase and Rutile. The National lead Co., 77, 4708-4709.
- Doğan, H., Ekinci, D., Demir, U.; 2013. Atomic scale imaging and spectroscopic characterization of electrochemically reduced graphene oxide. Surface Science, 611. 54-59.
- Edusi, C., Sankar, G., Parkin, I.P., 2012. The Effect of Solvent on the Phase of Titanium Dioxide Deposited by Aerosol-assisted CVD. Chem. Vap. Deposition, 18, 126–132.
- Fernandez-Garcia, M., Martinez-Arias, A., Hanson, J.C., Rodriguez, J.A., 2004.Nanostructured Oxides in Chemistry. Characterization and Properties. Chem. Rev, 104(9), 4063-4104.
- Finnegan, M.P., Zhang, H., Banfield J.F., 2008. Anatase Coarsening Kinetics under Hydrothermal Conditions As a Function of Ph and Temperature. Chem. Mater., 20, 3443–3449.
- Gablenz, S., Ltzke, D.V., Abicht, H.P., Neumann-Zdralek, J., 1998. Preparation of fine TiO2 powders via spray hydrolysis of titanium tetraisopropoxide. Journal of materials science letters, 17, 537-539.

- Glover, A. J., Cai, M., Overdeep, K.R., Kranbuehl, D.E. and Schniepp, H. C., 2011. In Situ Reduction of Graphene Oxide in Polymers. Macromolecules, 44, 9821– 9829.
- Gobal, F., Faraji, M., 2015. Electrochemical synthesis of reduced graphene oxide/TiO2 nanotubes/Ti for high-performance supercapacitors. Ionics, 21, 525–531.
- Goodridge, F., King, C. J. H.; 1974. Technique of Electroorganic Synthesis, Part 1, Weinberg, N. L., Ed., Wiley, NewYork.
- Guo, H.L., Wang, X.F., Qian, O.Y., Wang, F.B. and Xia, X.H., 2009. A green approach to the synthesis of graphene nanosheets. ACSNano, 3, 2653.
- Hanaor, D.A.H., Sorrell, C.C., 2011. Review of the anatase to rutile phase transformation. Journal of Materials Science ,46, 855–874.
- Harima, Y., Setodoi, S., Imae, I., Komaguchi, K., Ooyama, Y., Ohshita, J., Mizota, H., Yano, J., 2011. Electrochemical reduction of graphene oxide in organic solvents. Electrochimica Acta, 56, 5363–5368.
- Hayakawa, S., Wu, J. M., Tsuru, K., Osaka, A., 2002. Cryst. Growth Des., 2, 147-152.Hu, C.C., Huang, C.C., Chang, K.H., 2009. A novel solution for cathodic deposition of porous TiO2 films. Electrochemistry Communications, 11, 434– 437.
- Huang, C.C., Hsu, H.C., Hu, C.C., Chang, K.H., Lee, Y.F., 2010. Morphology control of cathodically deposited TiO2 films. Electrochimica Acta, 55, 7028–7035.
- Jin, Q., Ikeda, T., Fujishima, M., Tada, H., 2011. Nickel(II) oxide surface-modified titanium(IV) dioxide as a visible-light-active photocatalystw. Chem. Commun., 47, 8814–8816.
- Kandiel, T.A., Feldhoff, A., Robben, L., Dillert, R., Bahnemann, D.W., 2010. Tailored Titanium Dioxide Nanomaterials: Anatase Nanoparticles and Brookite Nanorods as Highly Active Photocatalysts. Chem. Mater., 22, 2050–2060.
- Karuppuchamy, S., Iwasakib, M., Minoura, H., 2007. Physico-chemical, photoelectrochemical and photocatalytic properties of electrodeposited nanocrystalline titanium dioxide thin films. Science Direct, 81, 708–712.
- Karuppuchamy, S., Nonomura, K., Yoshida, T., Sugiura, T., Minoura, H., 2002. Cathodic electrodeposition of oxide semiconductor thin films and their application to dye-sensitized solar cells. Solid State Ionics, 151, 19–27.
- Kauppila, J., Kunnas, P., Damlin, P., Viinikanoja, A., Kvarnström, C., 2013. Electrochemical reduction of graphene oxide films in aqueous and organic solutions. Electrochimica Acta, 89, 84–89.
- Kim, C. S., Okuyama, K., Nakaso, K., Shimada, M., 2004. Direct measurement of nucleation and growth modes in titania nanoparticles generation by a CVD method. J Chem Eng Jpn, 37(11), 1379-1389.
- Kolen'ko, Y. V., Kovnir, K. A., Gavrilov, A. I., Garshev, A. V., Meskin, P. E., Churagulov, B. R., Bouchard, M., Colbeau-Justin, C. Lebedev, O. I., VanTendeloo, G., Yoshimura, M., 2005. Structural, Textural, and Electronic Properties of a Nanosized Mesoporous ZnxTi1-xO₂-x Solid Solution Prepared by a Supercritical Drying Route. J. Phys. Chem., 109(43), 20303-20309.
- Komarneni, S., Rajha, R. K., Katsuki, H., 1999. Mat.Chem. Phys, 61, 50-54.
- Kulkarni, M., Mazare, A., Schmuki, P., 2016. Influence of anodization parameters on morphology of TiO₂ nanostructured surfaces. Adv. Mater. Lett., 7(1), 23-28.

- Lambert, T.N., Chavez, C. A., Sanchez, B., Lu, H. P., Bell, N. S., Ambrosini, A., Friedman, T., Boyle, T.J., Wheeler, D. R., Huber, D. L., 2009. Synthesis and Characterization of Titania-Graphene Nanocomposites. J. Phys. Chem. C, 113, 19812–19823.
- Laudise, R.A., 1970. The Growth of Single Crystals, (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ), 6, 261-265.
- Lee, S.H., Lee, H., Cho, M., Lee, Y., 2015. Facile electrochemical synthesis of titanium dioxide dendrites and their electrochemical properties. Chem. Commun., 51, 3391.
- Liang, Y.T., Vijayan, B.K., Gray, K.A., Hersam, M.C., 2011. Minimizing Graphene Defects Enhances Titania Nanocomposite-Based Photocatalytic Reduction of CO2 For Improved Solar Fuel Production. Nano Lett., 11, 2865–2870.
- Maeda, H., 1992. The Tumor Blood Vessel as an Ideal Target for Macromolecular Anticancer Agents. Journal of Controlled Release, 19, 315-324.
- Maijenburg, A. W., Veerbeek, J., Putter, R., Veldhuis, S. A., Zoontjes, M. G. C., Mul, G., Josep, M., Nielsch, K., Sch^aafer, H., Steinhart, M., Elshof, J. E., 2014. Electrochemical synthesis of coaxial TiO₂–Ag nanowires and their application in photocatalytic water splitting. J. Mater. Chem. A, 2, 2648-2656.
- Mao, M., Mei, L., Guo, D., Wu, L., Zhang, D., Li, Q., Wang, T., 2014. High electrochemical performance based on theTiO₂ nanobelt@few-layered MoS₂ structure forlithium-ion batteries. Nanoscale,6, 12350–12353.
- Mo, S., Ching, Y., 1991. Elektronic and optical properties of three phases of titanium dioxide: Rutile, anatase and brookite. Physical Review, 51, 13023-13032.
- Morales-Torres, S., Pastrana-Martínez, L.M., Figueiredo, J.L., Faria, J.L., Silva, A.M.T., 2012. Design of graphene-based TiO2 photocatalysts—a review. Environ Sci Pollut Res, 19, 3676–3687.
- Nolan, M., 2009. Molecular Adsorption on the Doped (110) Ceria Surface. J. Phys. Chem. C., 113, 2425–2432.
- O'Regan, B., Gratzel, M., 1991. A low-cost, high efficiency solar cell based on dyesensitized colloidal TiO2 films. Nature, 353, 737-739.
- Oliveira, A.G., Nascimento, J.P., Gorgulho, H.F., Martelli, P.B., Furtado, C.A., Figueiredo, J.L., 2016. Electrochemical synthesis of TiO2/Graphene oxide composite films for photocatalytic applications. Journal of Alloys and Compounds, 654, 514-522.
- Pfaff, G., Reynders, P., 1999. Angle-Dependent Optical Effects Deriving from Submicron Structures of Films and Pigments. Chem. Rev., 99, 1963-1981.
- Rabenau, A., 1985. The Role Hydrothermal Synthesis in Preparative Chemistry Angew. Chem. Int. Eng, 24, 1026-1040.
- Robin, A., Ribeiro, M., Rosa, L., Nakazato, R. Z., Silva, M. B., 2014. Formation of TiO₂ Nanotube Layer by Anodization of Titanium in Ethylene Glycol-H₂O. Electrolyte Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology, 4, 123-130Roy, R., 1994. Acceleration the Kinetics of Low-Temperature Inorganic Syntheses. J. State Chem, 111, 11-17.
- Ryu, W. H., Park, C.J., Kwon, H. S., 2008. J. Nano. Nano, 8, 1–4.
- Sankapal, B.R., Sartale, S.D., Lux-Steiner, M.C., Ennaoui, A., 2006. Chemical and electrochemical synthesis of nanosized TiO2 anatase for large-area photon conversion. C. R. Chimie, 9, 702-707.

- Sayılkan, F., 2007. Nano-TiO₂ Fotokatalizör Sentezi ve Fotokatalitik AktivitesininBelirlenmesi. İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 109s, Malatya.
- Shah, S.A.S., Park, A.R., Zhang, K., Park, J.H., Yoo, P.J., 2012. Green Synthesis of Biphasic TiO2–Reduced Graphene Oxide Nanocomposites with Highly Enhanced Photocatalytic Activity. ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 3893–3901.
- Sreeprasad, T.S., Samal, A.K. and Pradeep, T., 2009. Tellurium nanowire-induced room temperature conversion of graphite oxide to leaf-like graphenic structures. J.Phys.Chem C, 113 (5), 1727-1737.
- Swamya, V., Galeb, J.D., Dubrovinskyc, L.S., 2001. Atomistic simulation of the crystal structures and bulk moduli of TiO2 polymorphs. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 62, 887-895.
- Tang, Y.B., Lee, C.S., Xu, J., Liu, Z.T., Chen, Z.H. He, Z., Cao, Y.L., Yuan, G., Song, H., Chen, L., Luo, L., Cheng, H.M., Zhang, W.J., Bello, I., Lee, S.T., 2010. Incorporation of Graphenes in Nanostructured TiO2 Films via Molecular Grafting for Dye-Sensitized Solar Cell Application. American Chemical Society, 4, 3482-3488.
- Therese, G.H.A., Kamath, P.V., 2000. Electrochemical Synthesis of Metal Oxides and Hydroxides. Chem. Mater., 12, 1195-1204.
- Toh, S.Y., Loh, K.S., Kamarudin, S.K., Daud, W.R.W., 2014. Graphene production via electrochemical reduction of graphene oxide: Synthesis and characterisation. Chemical Engineering Journal, 251, 422–434.
- Tong, H., Zhu, J., Chen, J., Han, Y., Yang, S., Ding, B., Zhang, X., 2013. Electrochemical reduction of graphene oxide and its electrochemical capacitive performance. J Solid State Electrochem, 17, 2857–2863.
- Wang, D., Choi, D., Li, J., Yang, Z., Nie, Z., Kou, R., Hu, D., Wang, C., Saraf, L.V., Zhang, J., Aksay, I.A., Liu, J., 2009. Self-Assembled TiO2–Graphene Hybrid Nanostructures for Enhanced Li-Ion Insertion. American Chemical Society, 3, 907-914.
- Wang, W.S., Wang, D.H., Qu, W.G., Lu, L.Q., Xu, A.W., 2012. Large Ultrathin Anatase TiO2 Nanosheets with Exposed {001} Facets on Graphene for Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity. J. Phys. Chem. C, 116, 19893-19901
- Wanga, D., Yu, B., Zhoua, F., Wang, C., Liua, W., 2009. Mat. Chem. Phys., 113, 602–606.
- Williams, G., Seger, B., Kamat, P.V., 2008. TiO2-Graphene Nanocomposites. UV-Assisted Photocatalytic Reduction of Graphene Oxide. American Chemical Society, 2, 1487–1491.
- Wu, X., Jiang, Q. Z., Ma, Z. F., Fu, M., Shangguan, W. F., 2005. Solid State Commun, 136, 513-517.
- Yang, J., Gunasekaran, S., 2013. Electrochemically reduced graphene oxide sheets for use in high performance supercapacitors. Carbon, 51, 36-44.
- Zhang, H., Banfield, J. F., 2000. Understanding Polymorphic Phase Transformation Behavior during Growth of Nanocrystalline Aggregates: Insights from TiO2. J. Phys. Chem. B, 104, 3481-3487.
- Zhang, H., Banfield, J.F., 1998. Thermodynamic analysis of phase stability of nanocrystalline titania. J. Mater. Chem., 8(9), 2073–2076.

Zhu, Y., Li, H., Koltypin, Y., Hacohen, Y. R., Gedanken, A., 2001.Chem. Commun, 12, 2616-2621.



ÖZGEÇMİŞ

1991 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. 2009 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden, 2014 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nın Analitik Kimya Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansa başladı.

